

**Всесоюзный
Центр
Переводов**

**АНГЛИЙСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ
ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИБОРАМ**



МОСКВА • 1986

Государственный комитет СССР
по науке и технике

Академия наук
СССР

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДОКУМЕНТАЦИИ

В помощь переводчику

АНГЛИЙСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИБОРАМ

С о с т а в и т е л и
канд. техн. наук Н.А. Соболева, И.П. Вишневская

П о д р е д а к ц и е й
канд. физ.-мат. наук С.Х. Батыгова

Москва 1986

УДК 802.0=801.18:621.384

Ответственный редактор

И.И. Убин

© Всесоюзный центр переводов, 1986

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Данный выпуск содержит около 2 000 сокращений многословных терминов по электронным приборам, опубликованных в англоязычной технической литературе, и охватывает следующие разделы: электровакуумные приборы и их элементы, газоразрядные приборы, полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы, оптоэлектронные приборы - фотоприемники и полупроводниковые излучатели, в том числе полупроводниковые лазеры, индикаторные приборы, физические основы электронных приборов - электронная и ионная эмиссия, адсорбционные процессы, явления на поверхности твердого тела и методы диагностики поверхности, материалы электронной техники, методы их получения и контроля. Для большинства терминов даны русские эквиваленты, русские варианты сокращений приведены в тех случаях, когда соответствующие русские сокращения получили достаточно устойчивое применение. Замечания и предложения по содержанию выпуска просим направлять в адрес ВЦП: 117218, г. Москва, В-218, ул. Кржижановского, д. 14, кор. 1.

A

AA (active area)
активная область

ABO (automatic beam optimizer)
автоматический оптимизатор луча в установке электронолитографии

ACED (alternate current electroluminescent display)
электролюминесцентный индикатор в режиме переменного тока

ACFEL (alternate-current thin film electroluminescent)
см. АСТФЕЛ

ACEMS (angular conversion electron Mössbauer spectroscopy)
угловая конверсионная мёсбауэровская спектроскопия (метод определения состава поверхности и глубинного профилирования)

ACMOS (advanced complementary MOS)
улучшенный КМОП транзистор
АСРЕЛ (alternate-current powder electroluminescent)

электролюминесцентная панель с порошковым люминофором на переменном токе

ACRT (accelerated crucible rotation technique)

техника выращивания кристаллов с неравномерным /реверсивным/ вращением тигля

ACT (asymmetric crystal topography)
асимметричная топография кристалла

ACTFEL (alternate-current thin film electroluminescent)
тонкопленочная электролюминесцентная панель на переменном токе
см. также АСФЕЛ

AD (acceptor doping)
легирование акцепторной примесью

ADES (angle dispersed electron spectroscopy)
электронная спектроскопия с угловой дисперсией

ADP (ammonium dihydrogen phosphate)
дигидрофосфат аммония

ADT (alloy diffusion technique)
диффузионное легирование из сплава

AE (acoustic emission)
акустическая эмиссия

- AEAPS (Auger electron appearance potential spectroscopy)
спектроскопия потенциалов появления оже-электронов
- AEPECS (Auger-electron-photoelectron coincidence spectroscopy)
см. APECS
- AES (activation energy spectrum)
спектр энергий активации
- AES-IM (AES+ion milling)
электронная оже-спектроскопия с послынным ионным стравливанием /фрезерованием/
- A-IGFET (accumulation mode IGFET)
полевой транзистор с изолированным затвором в режиме накопления
- AIM (avalanche-induced migration)
миграция, индуцированная лавинным процессом
- ALE (atomic layer epitaxy)
эпитаксия атомарного слоя
- ALS (advanced low-power Schottky)
улучшенная технология маломощных приборов с барьером Шоттки
- AM 1(2) (air mass 1(2))
условия единичной /двойной/ воздушной массы /режим испытания солнечных элементов/
- AMB-layer (antimeltback layer)
барьерный /предохраняющий против подтравливания подложки/ слой
- AMC (asymmetry in modal confinement) laser
лазер с асимметричным распределением мод
- AMD (alkali metal dispenser)
диспенсерный источник паров щелочных металлов
- AM 0 (air mass Zero)
условия нулевой воздушной массы /режим испытания солнечных элементов/
- AMS (accelerator mass-spectrometry)
масс-спектрометрия ускоренных /в циклотроне/ ионов
- AND (alphanumeric display)
буквенно-цифровой дисплей
- AOD (acousto-optic deflector)
акусто-оптический дефлектор
- AOM (acousto-optic modulator)
акусто-оптический модулятор
- AP (atom-probe)
атомный зонд
- APECS (Auger-photoelectron coincidence spectroscopy)
оже-фотоэлектронная спектроскопия совпадений /реги-

страция оже- и фотоэлектронов, эмиттируемых в едином акте/
см. также АЕРЕС

APW (address path width)
ширина адресной шины

APCVD (atmospheric pressure CVD)
химическое осаждение из паровой фазы при атмосферном давлении

APFIM (atom-probe field-ion microscope)
автоэмиссионный ионный микроскоп в режиме атомного зонда

APS (appearance potential spectroscopy)
спектроскопия порогового потенциала /потенциала появления/

APS (atmospheric plasma spraying)
плазменное струйное распыление при атмосферном давлении

APW (augmented plane wave)
метод усиленной плоской волны

AR (antireflection)
противоотражающий

AR-technique (accelerated rotation technique)
техника выращивания кристаллов при вращении /тигля, заправки/ с ускорением

AR (angle resolved)
спектроскопия с угловым разрешением

ARC (antireflection coating)
противоотражающее покрытие

ARE (activated reactive evaporation)
активационное реактивное напыление

AREDS (angle resolved energy dispersive spectroscopy)
энергодисперсионная спектроскопия с угловым разрешением

ARIES (angle resolved ion-electron spectroscopy)
ионно-электронная спектроскопия с угловым разрешением

ARL (antistokes Raman laser)
лазер на антистоксовом комбинационном рассеянии

ARP (avalanche resonant pump)
накачка на лавинной частоте

ARP (angle-resolved photoemission)
см. ARPES

ARPEFS (angle-resolved photoemission extended fine structure)
тонкая структура запорогового спектра фотоэмиссии с угловым разрешением

ARPES (angle resolved photoemission spectroscopy)	ASPID (adsorption spectroscopy by polariton-induced desorption)
фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением	адсорбционная спектроскопия, основанная на десорбции, индуцированной поляритонами /метод исследования адсорбционных систем/
см. также ARP	
ARSES (angle resolved secondary-electron spectroscopy)	AT (ambient temperature)
вторично-электронная спектроскопия с угловым разрешением	температура окружающей среды
ARUPS (angle resolved ultraviolet photoemission spectroscopy)	AT (avalanche transistor)
	лавинный транзистор
УФ-фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением	ATE (anisotropic etch)
	анизотропное травление
ASE (amplified spontaneous emission)	ATT (accelerated test technique)
усиленное спонтанное излучение /суперлюминесценция/	метод ускоренных испытаний
ASES (arc source emission spectroscopy)	ATT (avalanche transit-time)
эмиссионная спектроскопия дугового источника	лавинопролетный
ASIC (application specific IC)	ATO (antimony-tin oxide)
ИС специфического применения	окись сурьмы-олова ($Sb_2O_3 + SnO_2$)
ASLEEP (automated scanning low-energy electron probe)	ATR (attenuated total reflection)
низкоэнергетический электронный зонд с автоматическим сканированием	нарушенное полное внутреннее отражение
	AVDP (automatic vacuum deposition)
	автоматизированная установка вакуумного осаждения

AZO (aluminium-doped zinc oxide)
оксид цинка, легированный алюминием /прозрачное проводящее покрытие/

В

VA-gauge (Bayard-Alpert) gauge
вакуумметр Байарда-Альперта

BAMBI (basic analyzer of MOS and bipolar devices)
программа фундаментального анализа МОП и биполярных приборов

BAMM (ballon-borne atmospheric mosaic measurement)
мозаичный измеритель атмосферного УФ излучения с ограниченным материалом баллона порогом

BANAN (barium-natrium niobat) $Ba_2NaNb_5O_{15}$
ниобат бария-натрия /НБН/ см. также BSH

BBAR (band-to-band Auger recombination)
межзонная оже-рекомбинация

BВН (buried-facet buried multi-hetero-structure)
скрытая многопереходная гетероструктура с зарощенной гранью

ВВНТ (ballistic bipolar heterojunction transistor)
баллистический биполярный гетеротранзистор

BVL (building-block layout)
метод проектирования СБИС на основе стандартных конструктивных блоков

BVM (beam brightness modulation)
модуляция яркости луча

BBS (bucket-brigade structure)
структура типа пожарной цепочки

BC-laser (buried crescent laser)
лазерный диод со скрытой серповидной активной областью

BCC (body-centred cubic)
объемо-центрированная кубическая решетка /ОЦК/

BСD (bulk charge-transfer device)
прибор с объемным переносом заряда

BC LDD PMOS (buried channel lightly doped drain PMOS)
МОП ПТ со скрытым р-каналом и слаболегированной областью стока

BCM (buried coarctate mesa-structure)
скрытая встечная меза-структура

- BCS (buried crescent structure)
скрытая серповидная активная область
- BCTC (bistable cholesteric twist cell)
бистабильная жидкокристаллическая ячейка на эффекте скручивания холестерической фазы
- BDG (back-surface damage gettering)
getterирование путем создания механически нарушенного слоя на тыловой поверхности
- BDT (bidirectional transducer)
двумерный преобразователь ПАВ
- BE (bound exciton)
связанный экситон
см. также BES
- BEI (backscattered electron imaging)
получение изображения объекта в обратнорассеянных электронах
- BEp (beam equivalent pressure)
давление, эквивалентное плотности пучка молекул /в молекулярно-лучевой эпитаксии/
- BES (bond exciton state)
см. BE
- BFET (bipolar-mode FET)
полевой транзистор в режиме биполярного
- BFET (ballistic FET)
баллистический ПТ /с коротким каналом/ /БПТ/
- BF(I) (bright-field image)
светлопольное изображение /в электронной микроскопии/
- BGN (band-gap narrowing)
сужение запрещенной зоны
- BGO ($\text{Bi}_4\text{Ge}_3\text{O}_{12}$)
германат висмута /сцинтиллятор/
- BGR (buried giga-ohm resistor)
структура со скрытым гигаомным резистором /ячейка памяти/
- BHS (buried heterostructure)
см. BH
- BH (buried heterostructure)
скрытая /зарощенная/ гетероструктура
см. также BHS
- BIC (buried isolation capacitor)
конденсатор со скрытым изолирующим слоем
- BICEPS (Bell IC engineering process simulation)
моделирование процесса производства ИС фирмы Белл
- BIG (bundle-integrated-guide)
интегральная многоволноводная структура

ВІРМОS (bipolar-MOS)
 биполярная и МОП структуры на общей подложке

ВІМРЛОХ (buried implanted oxide)
 скрытый слой окисла, полученный ионной имплантацией

ВІS (bremsstrahlung isochromatic spectroscopy)
 спектроскопия изохроматического тормозного уф-излучения /электрон-фотонная спектроскопия/
 см. также UBIS, IPES, IPE

ВJFET (bipolar junction FET)

ПТ с управляющим рп переходом

ВJТ (bipolar junction transistor)
 планарный биполярный транзистор

ВLIP (background-limited infrared photodetector)
 приемник ИК излучения в режиме ограничения фоном /в ОФ-режиме/

ВLЕ (bombardement-induced light emission)
 оптическое излучение, индуцированное ионной /электронной/ бомбардировкой

ВLIP (background-limited performance)
 режим ограничения фоном /ОФ-режим/

ВМН-laser (buried multi-heterostructure laser)
 лазерный диод со скрытой многопереходной гетероструктурой

ВМQW (buried multi-quantum well)
 скрытая многослойная структура с квантовыми ямами

ВN (boron nitride)
 нитрид бора

ВOG (buried optical guide)
 скрытый /зарощенный/ оптический волновод

ВО-MOS (buried-oxide MOS)
 МОП-структура со скрытым слоем изолирующего окисла

ВРВТ (ballistic permeable-base transistor)
 баллистический транзистор с проницаемой базой

ВРSГ (borophosphor-silicate glass)
 боро-фосфорносилкатное стекло

ВRІ (Bragg reflection imaging)
 электронография брэгговского отражения

ВRS (backscattering Rutherford spectroscopy)
 спектроскопия обратного резерфордского рассеяния быстрых ионов
 см. также RBS

BRSL (buried ridge structure laser)
лазерный диод со скрытой реберной структурой

BS (backscattering spectrometry)
спектрометрия обратно-рассеянных частиц

B-S-technique (Bridgmen-Stockbarger technique)
метод выращивания монокристаллов Бриджмена-Стокбаргера

BSF (back-surface field)
поле, встроенное у тыловой поверхности /солнечного элемента/

BSIS (broad-channeled substrate inner stripe)
/лазерный диод/ с широким встроенным полосковым каналом в подложке

BSITIC (bipolar static induction transistor IC)
интегральная микросхема на биполярных транзисторах со статической индукцией

BSN (barium-sodium niobat) $Ba_2NaNb_5O_{15}$
см. BANAN

BSR-contact (back surface reflection contact)
тыловой отражающий контакт /в солнечных элементах/

BT (bipolar transistor)
биполярный транзистор

BN-stress aging (bias-temperature stress aging)
термополевое старение

BTRS (buried twin-ridge substrate)
скрытая двойная реберная структура в подложке

BTT (breakdown-temperature test)
температурные испытания при пробивном напряжении

BTT (base transit time)
время пролета через базовую область

B-U-electron gun (bi-potential-unipotential electron gun)
гибридная /бипотенциальная-унипотенциальная/ электронная пушка

BV (bias voltage)
напряжение смещения

BV (breakdown voltage)
напряжение пробоя

BW (bandwidth)
ширина /частотной/ полосы

BW CMOS (bi-well CMOS)
КМОП структура с двойным карманом /"карман в кармане"/

BWM (backward-wave magnetron)
лампа обратной волны М-типа

BWO (backward-wave oscillator)
см. BWT
BWT (backward-wave tube)
лампа обратной волны /ЛОВ/
см. также BWO
BZ (Brillouin zone)
зона Бриллюэна

С

CACRT (Czochralski accelerated crucible (and crystal) rotation technique)
метод Чохральского с неравномерным вращением тигля /и кристалла/
CADIC (computer-aided design of IC)
машинное проектирование ИС
CAIBE (chemically assisted ion beam etching)
ионно-лучевое травление с химическим действием
CAM (computer-aided manufacturing)
гибкое автоматизированное производство /ГАП/
см. также CAT
CAMFET (camel gate field effect transistor)
ПТ с затвором на пьедестале

CAND (colour alphanumeric display)
цветной буквенно-цифровой дисплей

CARIS (constant angle reflection interference spectroscopy)
интерференционная спектроскопия при постоянном угле отражения

CARS (coherent anti-stokes Raman scattering)
когерентное антистоксово комбинационное рассеяние света /КАРС/

CASFET (cascode MOSFET)
внутренняя каскадная схема на МОП ПТ с коротким скрытым каналом

CAT (computer-aided technology)
см. CAM

CAT (cooled anode tube)
электронная лампа с охлаждаемым анодом

CB (conduction band)
зона проводимости

CB (common base)
общая база

CB (controlled birefringence)
управляемое двулучепреломление

CBV (conduction band bottom)
дно зоны проводимости

CBC (collector-base current)	CCC (corrugated capacitor cell)
ток коллектор - база	гофрированный конденсатор
CBC (common base circuit)	CCC (C ³) (cleaved coupled cavity)
схема с общей базой	связанный по сколу резонатор
CBD (convergent beam diffraction)	CCD (cold cathode discharge)
дифракция сходящегося пучка	разряд с холодным катодом
CBE (chemical beam epitaxy)	CCD (charge carriers depletion)
химическая лучевая эпитаксия /комбинация молекулярно-лучевой эпитаксии и химического осаждения из паровой фазы металлоорганических соединений/ см. также МО-МВЕ	обеднение носителями заряда
CBED (convergent beam electron diffraction)	CCD (charge carrier density)
дифракция сходящегося пучка электронов	концентрация носителей заряда
CBFS (caesium beam frequency standard)	CCD (custom circuit design)
цезиевый стандарт частоты	разработка заказных ИС
CBU (coefficient of beam utilization)	CCF (circular core fiber)
коэффициент использования луча	оптическое волокно с круглым сердечником
CC (common collector)	CCI (charge carrier injection)
общий коллектор	инжекция носителей заряда
CC (chip carrier)	CCIRID (charge coupled infrared imaging device)
кристаллодержатель, подложка	преобразователь ИК-изображения на ПЗС
CCA (chip-by-chip alignment)	CCM (charge carrier mobility)
покристальное совмещение	подвижность носителей заряда
	CCM LD (current confinement mesa-substrate laser diode)
	лазерный диод с ограничением тока на меза-подложке

CCNI (current-controlled negative inductance)	CCTWT (coupled-cavity TWT)
управляемая током отрицательная индуктивность	лампа бегущей волны со связанными резонаторами
CCP (chrome circuit pattern)	CD (climbing dislocation)
хромовый фототаблон	переползающая дислокация
CCP (cross-connecting point)	CD (chip density)
точка перекрестного соединения	плотность упаковки /в ИС/
CCR (C^2R) (charge control ring)	CL (co-deposited)
кольцеобразная защитная структура, ограничивающая распространение зарядов в силовом транзисторе	полученный совместным осаждением
CCRT (cathodochromic cathode-ray tube)	CDA (cylindrical deflector analyser)
ЭЛТ с катодохромным экраном	цилиндрический энергоанализатор с отклонением пучка
CCSR (charge coupled shift register)	CDD (charge domain device)
регистр сдвига на ПЭС	прибор на зарядовых доменах /на эффекте Ганна/
CCT (crystal cutting technique)	CDD (concentration-dependent diffusion)
техника разрезания кристалла	концентрационно-зависимая диффузия
CCT (conductivity controlled transistor)	CDF (charge domain filter)
транзистор с управляемой проводимостью	фильтр на зарядовых доменах
CCTC (capillary channel type conductivity)	CDH-laser (constricted double heterojunction laser)
проводимость, зависящая от сечения канала	двойной гетеролазер с ограничением
	CDL (characteristic diffusion length)
	характеристическая длина диффузии

CDS (capacitor-diode storage)	CEPIC-process (complementary epitaxial passivated IC process)
диодно-конденсаторное ЗУ	технология комплементарных эпитаксиальных пассивированных ИС
CDS (comprehensive display system)	CER (cost-efficiency ratio)
дисплейная система с высоким качеством отображения	отношение стоимость/эффективность
CDT (chip design technique)	CERMET (ceramic-metal)
метод проектирования микросхем	кермет
CDW (charge density wave)	CERP (carbon fibre reinforced plastics)
волна плотности заряда	пластмасса, армированная угольным волокном
CEC (common emitter circuit)	CES (controllable emitter shorts thyristor)
схема с общим эмиттером	тиристор с управляемым шунтированием эмиттера
CEF (complementary emitter follower)	CEV (collector-emitter voltage)
эмиттерный повторитель на КМОП структурах	напряжение коллектор-эмиттер
CEL (contrast enhanced lithography)	CF (conversion factor)
контрастная литография	коэффициент преобразования
CELS (characteristic energy loss spectroscopy)	CF (cathode follower)
спектроскопия характеристических потерь энергии /электронов/	катодный повторитель
CEM (channel electron multiplier)	CFA (crossed-field amplifier)
канальный электронный умножитель /КЭУ/	СВЧ усилительная лампа со скрещенными полями /М-типа/
CEMA (channel electron multipliers array)	
матрица канальных электронных умножителей	

CFEM (crossed field electron multiplier)
электронный умножитель со скрещенными полями
см. также CFM

CFET (charge field-effect transistor)
зарядовый полевой транзистор

CFI (crystal frequency indicator)
кварцевый индикатор частоты

CFM (crossed field multiplier)
см. CFEM

CFP (crossed-field photomultiplier)
см. CFPM

CFPM (crossed-field photomultiplier)
фотоэлектронный умножитель /ФЭУ/ со скрещенными полями
см. также CFP

CFS (constant final-state spectroscopy)
электронная спектроскопия в условиях постоянства конечных состояний

CFT (charge-flow transistor)
транзистор с растеканием носителей заряда

CG (cathode grid)
катодная сетка

CG (control grid)
управляющая сетка

CG (cross-gate) CCD
ПЗС с перекрестными затво-

рами /затворы в нижнем и верхнем слоях на окисной изоляции расположены горизонтально и вертикально/

CGI (compressed-gas insulation)
изоляция сжатым газом

CHA (concentric hemispherical analyzer)
концентрический полусферический энергоанализатор

CHE (channel hot electron)
/инжекция/ горячих электронов из канала

CHEMFET (chemical FET)
полевой хемотранзистор /электрохимический ПТ/

CHIC (ceramic hybrid IC)
гибридная ИС на керамической подложке

CHIP (chip hermeticity in plastic)
герметизация пластмассой

CMOS III (complementary high-performance MOS-III)
технология масштабированных КМОП ИС высокого качества III поколения /с n-карманом/

CMOS (complementary hybrid MOS)
гибридная КМОП структура / комбинация E/D CMOS + + E/E CMOS /
см. также HCMOS

СНТ (CdHgTe) теллурид кадмия-ртути	CII (channeled ion implantation) направленная ионная им- плантация
ChVs (chalcogenide vitreous semiconductor) халькогенидный стеклооб- разный полупроводник	CIM (charge imaging matrix) матричный зарядовый пре- образователь изображения
CIBE (cluster ion beam evaporation) напыление /пленок/ с ис- пользованием пучка ионных кластеров	CIS (constant initial- state spectroscopy) электронная спектроскопия в условиях постоянства начальных состояний
CIBL (conventional ion- beam lithography) традиционная ионно-лучевая литография	C-LEC (computer-cont- rolled liquid encap- sulation Czochralski) метод Чохральского с жид- костной герметизацией с управлением от ЭВМ
CIC (compatible IC) совместимая ИС	CLS (characteristic loss spectroscopy) см. CELS
CIC (consume IC) потребительская ИС	CMA (cell memory array) матричное ЗУ
CIC (custom IC) заказная ИС	CMF (contrast modula- tion function) частотно-контрастная ха- рактеристика /ЧКХ/ см. также MTF
CID (compositional interdiffusion) метод взаимной диффузии	CMR (contact microra- diography) автордиография
CID (collector insu- lation diffusion) коллекторная изолирующая диффузия /КИД/	CMS (compositionally modulated structure) структура из материала с модуляцией состава
CID (charge image device) устройство отображения на зарядовых приборах	CMT (conjunction-mask technique) метод сопряжения масок /в технологии ИС/
CID (controlled inver- sion device) прибор с управляемой ин- версией	
CIG (chemical ion generator) химический ионный источ- ник	

CNS (channeled-substrate narrow stripe)	CPD (contact potential difference)
узко-полосковая структура с каналом в подложке	контактная разность потенциалов /КРП/
CO (crystal oscillator)	CPE (composition pulling effect)
кварцевый вибратор	эффект вытягивания состава
см. также XO	ва
COD (catastrophic optical damage)	CPM (channel-plate multiplier)
катастрофическое оптическое разрушение	электронный умножитель с микроканальной пластиной
COG (chip on glass)	CPM (channel photomultiplier)
технология ИС на стеклянной подложке	канальный фотоумножитель
COMFET (combined FET)	CPM-laser (colliding-pulse mode-locked laser)
силовой ПТ, изготовленный по комбинированной МОП и биполярной технологии	лазер с модулированной добротностью на встречных пучках
COMFET (conductivity modulated FET)	CR (cyclotron resonance)
мощный МОП ПТ с модулированной проводимостью /с повышенной путем инъекции неосновных носителей проводимостью n -области стока/	циклотронный резонанс
COS (colour separation)	CRD-cathode (cavity-reservoir dispenser cathode)
цветоделительный	распределительный катод с запасом эмиссионного вещества
CP (ceramic package)	CRIS (cyclotron resonance ion source)
керамический корпус	ионный источник на основе циклотронного резонанса
CPAA (charged particle activation analysis)	CRN (continuous random network) model
активационный анализ с возбуждением заряженными частицами	непрерывная хаотичная сетка /модель структуры аморфного материала/

Cross-MOS-transistor
 ПТ с двумя затворами с до-
 полняющими каналами на до-
 каждой поверхности ре-
 кристаллизованного слоя
 поликремния /для снижения
 эффекта короткого канала/
 см. также X MOS

CRT (charactron tube)
 характрон, ЭЛТ с матрич-
 ным экраном знаков

CRTM (cathode ray
 tube memory)
 ЗУ на ЭЛТ

CRYEBIS (cryogenic
 electron-beam ion
 source)
 ионный источник с элект-
 ронно-лучевой ионизацией
 и со сверхпроводящим
 магнитом

CS (circular scanning)
 круговая развертка

CSA (coaxial-to-strip
 adapter)
 коаксиально-полосковое
 соединение

CSBH (channeled-sub-
 strate buried hetero-
 structure)
 скрытая гетероструктура
 с каналом в подложке

CSC (crossed strip
 cryotron)
 пленочный криотрон со
 скрещенными полосковыми
 электродами
 см. также CFC

CSD (charge sweep
 device)
 прибор с вытягиванием за-
 рядов

CSE (charge storage
 element)
 элемент с накоплением за-
 ряда

CSL (coincident site
 lattice)
 решетка совпадающих узлов

CSOS (complementary
 silicon on sapphire)
 комплементарная ИС, изго-
 товленная по технологии
 "кремний-на-сапфире"

CSP (channeled-sub-
 strate planar)
 планарный /лазерный диод/
 с каналом в подложке

CSP (chemical spray
 pyrolysis)
 пиролиз пульверизованно-
 го раствора

CSSD (chemically sen-
 sitive semiconductor
 device)
 хемочувствительный полу-
 проводниковый прибор

CSVT (close space
 vapour transport)
 газовый транспорт при
 близком расположении ис-
 точника и подложки

CTC (conductive trans-
 parent coating)
 прозрачное проводящее
 покрытие
 см. также TCC

CTDM (charge transfer diode memory)
ЗУ на приборах с переносом заряда

CTO (cadmium-tin oxide)
оксид кадмия-олова

CTO (conductive transparent oxide)
прозрачный проводящий окисел

CTR (chemical transport reaction)
химическая транспортная реакция /ХТР/

CTS (current-transient spectroscopy)
спектроскопия переходного тока

CTT (carrier transit time)
время пролета носителей заряда

CTT (cartridge type transistor)
транзистор в корпусе в виде патрона

CUJT (complementary unijunction transistor)
комплементарная схема на однопереходных транзисторах

CV-method (capacitance-voltage method)
метод вольт-фарадных характеристик /ВФХ/

CVE (critical voltage effect)
эффект критического напряжения /в просвечивающем электронном микроскопе/

CVP (controlled vapour pressure)
регулируемое давление пара

CVT (chemical vapor transport)
химический паровой транспорт

CW (continous wave)
непрерывный режим излучения

CWIC (custom-wired IC)
ИС со специальной разводкой /полузаказная ИС/

CZS (CZ-silicon)
кремний, выращенный по методу Чохральского

D

DA (diode array)
диодная матрица

DA (donor-acceptor)
см. DAP

DAHC-MOSFET (drain avalanche hot carrier MOSFET)
МОП-транзистор с лавинным умножением горячих носителей в области стока

1DAL (2DAL, 3 DAL) (one (two, three)-dimensional active layer)
/лазерный диод/ с одномерным /дву-, трехмерным/

активным слоем /с кванто-
во-размерным эффектом/

DAP (donor-acceptor
pair)

донор-акцепторная пара
/ДАП/

см. также ДА (donor-accep-
tor

DAP-transistor (diffus-
ed alloy power tran-
sistor)

мощный диффузионно-сплав-
ной транзистор

DAPS (disappearance
potential spectroscopy)

спектроскопия потенциала
отсечки

DAR (double avalanche
region)

область с двумя лавинными
процессами

DAR IMPATT (double
avalanche region
IMPATT)

ЛПД с двумя лавинными об-
ластями /двухлавинный
ЛПД/

DAZD (double anode
Zener diode)

стабилитрон с двойным ано-
дом

DBD (double-base
diode)

двухбазовый диод

DBS (direct broad-
casting sattelit)

прямое спутниковое веща-
ние

DBS (dielectric break-
down strength)

электрическая прочность
диэлектрика

DBT (depleted base
transistor)

биполярный транзистор с
обедненной базой

DC (dual-control-
gate)

/полевой транзистор/ с
двойным управляющим за-
твором

DC-laser (double-chan-
nel laser)

двухканальный лазерный
диод

DC (driver cell)

ячейка формователя

DC (directional
coupler)

направленный ответвитель

DCBH (double-channel
buried heterostruc-
ture)

скрытая гетероструктура
с двойным каналом /в под-
ложке/

DCC (double current
confinement)

двойное ограничение тока
/в лазерном диоде/

DCD (double-crystal
X-ray diffractometry)

рентгеновская дифракто-
метрия на двух кристаллах

DCDS (direct current
diode sputtering)

метод диодного катодного
распыления на постоянном
токе

- DCFEM (dynamic crossed field electron multiplier)
динамический электронный умножитель со скрещенными полями
- DCM (double channel mesa-structure)
двухканальная меза-структура
- DCPBH (double-channel planar buried heterostructure)
планарная скрытая гетеро-структура с двойным каналом /в подложке/
- DCPDP (direct current plasma display panel)
газоразрядная индикаторная панель постоянного тока
- DC PEL (direct current powder electroluminescent)
электролюминесцентная /панель/ с порошковым люминофором на постоянном токе
- DC TFEL (direct current thin film electroluminescent)
тонкопленочная электролюминесцентная /панель/ на постоянном токе
- DD (donor doping)
легирование донорной примесью
- DDD (double diffused drain)
/транзистор/ с областью стока, образованной двойной диффузией
- DD IMPATT (double drift IMPATT)
двухпролетный ЛПД в режиме ударной лавины
- DDLTS (double-correction (correlation) DLTS)
релаксационная спектроскопия глубоких уровней с двойной коррекцией /корреляцией/
- DDM (double-diffused mesa)
меза-структура с двойной диффузией
- DD-MOS (deep depletion MOS)
МОП структура с глубоким обеднением
- DDR (double drift region)
пространство двойного дрейфа /в ЛПД/
- DDR (dry developed resist)
резист с сухим проявлением
- DDS (doped deposited silica)
кварц, легированный в процессе осаждения
- DDS (dual-level double-lift-off substitutional-gate)
замена материала электрода затвора с помощью двухслойного резиста и двухкратной взрывной технологии /при изготовлении быстродействующих ИС на GaAs /

DDT (double-diffused transistor)	DET (double-emitter transistor)
транзистор, изготовленный методом двойной диффузии	двухэмиттерный транзистор
2D-E (two-dimensional electron gas)	DET (domain extinction time)
см. 2DEG, TEG	время распада домена
DEAP (diffused eutectic aluminium process)	DEZn (diethylzinc)
процесс диффузии в область базы при плавлении эвтектики Al-Si путем пропуска обратного тока	диэтилцинк
DEBWL (direct electron beam on wafer lithography)	DF (dark-field)
электронолитография с непосредственным получением изображения на пластине	темнопольное изображение /в электронной микроскопии/
2DEG (two-dimensional electron gas)	DF (dislocation-free)
двумерный электронный газ см. также 2D-E, TEG	бездислокационный
DEM (double-exposure method)	DFA (double filter analyzer)
метод двойной экспозиции	энергоанализатор с двойным фильтром
DEP (dry etching process)	DFD(L) (distributed feedback dye laser)
процесс сухого травления	лазер на красителях с рас- пределенной обратной связью
DES (dry etching system)	D-FET (depletion-mode FET)
установка сухого травления	ПТ в режиме обеднения
DES (de-excitation spectroscopy)	DFPS (double floating probes system)
деактивационная спектроскопия	система с двумя плавающими зондами
	DFR (dry film resist)
	пленочный резист сухого проявления
	DFTS (dispersive Fourier transform spectroscopy)
	дисперсионная фурье-спектроскопия

DG (diode gate)
диодный вентиль

DG (double-groove)
структура с двойной канавкой

DGC (drain-gate capacitance)
емкость промежутка затвор

DG/DP (double groove/
double petticoat)
двойная канавка/двойная
изолирующая юбка

DGS (density of gap states)
плотность состояний в за-
преженной зоне

DGTET (dual gate thin film transistor)
тонкопленочный транзистор с двойным затвором

2D-H (two-dimensional hole gas)
см. 2DHG

DHBT (double heterojunction-bipolar transistor)
биполярный транзистор с двойным гетеропереходом

DHC (directly heated cathode)
катод прямого накала

D-HEMT (depletion-mode HEMT)
транзистор с высокой подвижностью электронов в режиме обеднения

2DHG (two-dimensional hole gas)
двумерный дырочный газ
см. также THG

DHL (double hetero-structure laser)
см. DHLD

DHLD (double hetero-structure laser diode)
лазерный диод с двойной гетероструктурой, двойной гетеролазер
см. также DHL

DI (degree of integration)
степень интеграции

DI (double carrier injection)
двойная инжекция носителей

DIBL (drain-induced barrier lowering)
понижение барьера под воздействием стока

DIBS (dual-ion-beam sputtering)
распыление /мишени/ двойным ионным пучком

DIC (dual-in-line ceramic)
керамический корпус с двухрядным расположением выводов

DICMOS (diode-clocked MOS)
МОП инвертор с диодом в качестве прерывателя

DID (diffusion-induced dislocations)
дислокации, введенные в процессе диффузии

DIGBM (diffusion-induced grain-boundary migration)	DL (delay line)
индуцированная диффузией миграция границ зерен	линия задержки
D-IGFET (depletion-mode insulated-gate field effect transistor)	DL (double LOCOS)
ПТ с изолированным затвором в режиме обеднения	двухэтапное локальное окисление
DIMOS (double injection MOS)	DLC (diamond-like carbon)
МОП структура с двойной инжекцией	алмазоподобный углерод
DIMPATT (distributed IMPATT)	DLD (dark line defect)
ЛПД с распределенными параметрами	дефект типа темной линии
DIRCOUP (directional coupler)	DLFS (deep level Fourier spectroscopy)
направленный ответвитель	Фурье-спектроскопия глубоких уровней
DIW (deionized water)	DLHJ (double-layer heterojunction)
деионизованная вода	двуслойный гетеропереход
DJ (deep junction)	DLOS (deep level optical spectroscopy)
глубокий переход	оптическая спектроскопия глубоких уровней
DJI (diffused junction isolation)	DLPT (double-level polysilicon technique)
изоляция диффузионным рп переходом	двухуровневый поликремниевый процесс
DL (defect level)	DLR (double-layer resist)
уровень дефекта	/литография/ с двухслойным резистом /двухслойное маскирование/
DL (depletion layer)	DLT (depletion load transistor)
обедненный слой	нагрузочный транзистор в режиме обеднения
DL (dielectric layer)	DM (diffused mesa)
слой диэлектрика	диффузионная меза-структура
DL (deformation luminescence)	
деформационная люминесценция	

DMD (depletion-mode device)	DOS (density of states)
прибор в режиме обеднения	плотность состояний
DMOS (discrete MOS)	DOVATT (double velocity avalanche transit-time)
дискретный МОП ПТ	ЛПД с двумя дрейфовыми областями
D-MOS (depletion mode MOS)	DP (diode plate)
МОП структура в режиме обеднения	диодная пластина
DMPX (demultiplexer)	DPC (differential photocurrent)
демультиплексор	метод измерения дифференциальной фотопроводимости
см. также DMX	DPF (dense plasma focus)
DMS (diluted magnetic semiconductor)	мощная плазменная пушка
разбавленный магнитный полупроводник	DPR (dry processed resist)
DMT (depletion-mode transistor)	резист сухого проявления
транзистор в режиме обеднения	DPT (Darlington power transistor)
DMX (demultiplexer)	монокитный усилительный каскад /схема Дарлингтона/ на двух транзисторах
см. DMPX	DPT (diffused planar transistor)
DMXO (dual-mode quartz crystal oscillator)	диффузионный планарный транзистор
двухмодовый кварцевый вибратор	DQE (differential quantum efficiency)
DmZn, (dimethylzinc) (DMZn)	дифференциальная квантовая эффективность
диметилцинк	DQW (double quantum well)
DLTS (deep level transient spectroscopy)	структура с двумя квантовыми ямами
релаксационная спектроскопия глубоких уровней /РСГУ/	DRIFT (diffuse reflection IR Fourier-transform)
DOFIC (domain-originated functional IC)	Фурье-спектроскопия диф-
функциональная ИС на эффекте Ганна	

фузного отражения ИК
излучения

DSC (differential
scanning calorimetry)
дифференциальная скани-
рующая калориметрия
/ДСК/

DSD (dark-spot
defect)
дефект типа темной точки

DSE (dynamic scatter-
ing effect)
эффект динамического рас-
сеяния
см. также DSME

DSI (double Schottky
interdigitated)
/фотоприемник/ с двойным
встречно-штыревым /гре-
бенчатый/ электродом Шот-
тки

DSIMS (dynamic SIMS)
динамическая вторично-
ионная масс-спектрометрия

DSL (doping super-
lattice)
легированная сверхрешетка
/образованная слоями n-
и p-типа проводимости/

DSM (dynamic single-
mode)
динамический одномодовый
режим генерации

DSME (dynamic scatter-
ing mode effect)
см. DSE

DSMSL (dynamic single-
mode semiconductor
laser)
полупроводниковый лазер в

динамическом одномодовом
режиме

DSPE (double SPE)
двукратная твердофазная
эпитаксия

DSRD (drift step reco-
very diode)
диод со скачкообразным
/очень быстрым/ восста-
новлением

DSSF (double-sided
surface field)
двухстороннее приповерх-
ностное встроенное поле

DSW (double Si-
wiring)
двухуровневая поликрем-
ниевая разводка

DSWL (direct step-on-
wafer lithography)
литография с помодульной
фотомультипликацией пря-
мо на пластину

DSWP (direct step-on-
wafer processing
(printing))
процесс прямого переноса
топологического рисунка
на пластину
см. также DSWT

DSWT (direct stop-on-
wafer technique)
см. DSWP

DT (diffusion transis-
tor)
диффузионный транзистор

DT (discharge tube)
разрядник

DIC (deposition thickness controller)
регулятор толщины осаждаемого слоя

DTCXO (digital temperature compensated quartz crystal oscillator)

кварцевый вибратор с цифровой температурной компенсацией

DIFT (depletion-mode TFT)

тонкопленочный транзистор в режиме обеднения

DUVCP (deep UV contact printing)

контактная фотолитография на глубоком /жестком/ УФ излучении /190-250 нм, разрешение < 0,5 мкм/

DUVL (deep UV lithography)

фотолитография на глубоком /жестком/ УФ излучении /190-250 нм, разрешение < 0,5 мкм/

D-V-MOS (double-diffusion V-MOS)

МОП структура с V-образной канавкой, полученная методом двойной диффузии

D-V-MOS (double-implanted V-MOS)

МОП структура с V-образной канавкой, полученная методом двойной ионной имплантации

DWE (direct wafer exposure)

прямое формирование рисунка на пластину

DWEBL (direct writing electron-beam lithography)

электронолитография с прямой записью топологического рисунка

DWSREBE (direct writing step-and-repeat electron-beam exposure)

прямое электронно-лучевое экспонирование с мультипликацией

DX (donor-vacancy complex)

комплекс донор-вакансия

Е

EA (electroabsorption)
электропоглощение /эффект Франца-Келдыша/

EAF (electron-arc furnace)
электронно-дуговая печь

EAL (electromagnetic amplifying lens)
электромагнитная усиливающая линза

EAMOS (electrically alterable MOS)
электрически перепрограммируемая ИС на МОП-транзисторах

EAP (electroabsorption avalanche photodiode)

лавинный фотодиод с электропоглощением /с использованием эффекта Франца-Келдыша/

EAPEs (extended appearance potential fine structure)	EBE (electron beam exposure)
тонкая структура протяженного спектра потенциала появления	электронно-лучевое экспонирование
EB (emitter-base)	EBG (electron-beam gun)
промежуток эмиттер - база	электронно-лучевой прожектор
E-B (emitter-base)	EBIV (electron beam induced voltage)
переход эмиттер - база	наведенное /электронным лучем/ напряжение
EBAL (electron-beam array lithography)	EBM (electron beam melting)
матричная электролитография	электронно-лучевая плавка
EBB (electron-beam bonding)	EBME (electron beam metal evaporation)
электронно-лучевая сварка	электронно-лучевое испарение металла
EBCVD (electron beam assisted chemical vapour deposition)	EBMF (electron beam microfabricator)
химическое осаждение из паровой фазы с электронно-лучевой стимуляцией	электронно-лучевой микроманипулятор /в электролитографии/
EBDSL (electron-beam direct-stepping-on-wafer lithography)	EBP (electron-beam proximity printing)
электрoлитoграфия с проекцией топологического рисунка непосредственно на пластину	электронно-лучевая контактная печать
EBE (electron beam evaporation)	EBP (etch-back process)
электронно-лучевое напыление	процесс вытравливания канавки в подложке с последующим ее заполнением
EBCS (electron-beam controlled switch)	EBR (electron beam remelting)
переключатель, управляемый электронным лучем	электронно-лучевая переплавка
	EBR (electron beam resist)
	электронорезист

EBS (electron beam scanning)	ECDCT (electrochemical diffused collector transistor)
электронно-лучевое сканирование	электрохимический транзистор диффузионным коллектором
EBS (energy band structure)	ECF (electroconductive film)
структура энергетической зоны	электропроводящая пленка
EBS (electron back-scattering pattern)	ECF (elliptical core fiber)
изображение в обратнорассеянных электронах /в РЭМ/	оптическое волокно с эллиптическим сердечником
EBS (electron beam slice printer)	ECL (external cavity laser)
установка для электронолитографии на пластине	лазер с внешним резонатором
EBT (emitter balast transistor)	ECO-laser (embedded confining-layer on optical guide laser)
транзистор с балластным резистором в цепи эмиттера	лазерный диод со встроенным ограничивающим слоем на волноводе
EBT (electron beam technology)	ECF (electron channelling pattern)
электронно-лучевая технология	картина каналирования электронов /в РЭМ/
EBW (electron beam welding)	ECR (electron cyclotron resonance)
электронно-лучевая сварка	электронный циклотронный резонанс
EC (electron capture)	ECRH (ECR-heating)
захват электронов	нагрев с помощью электронного циклотронного резонанса
EC (emission current)	ECR-IS (ECR ion source)
эмиссионный ток	ионный источник с разогревом плазмы электронным циклотронным резонансом
ECC (etched coupled-cavity)	
связанный резонатор, полученный травлением	
ECD (energy conversion device)	
преобразователь энергии	

ECR-PD (ECR plasma deposition) метод плазменного осаждения с использованием электронного циклотронного резонанса	EDOЕ (energy distribution of output electrons) энергетическое распределение эмиттированных электронов
ECS (electron capture spectroscopy) спектроскопия электронного захвата	EDOS (electronic density of states) плотность электронных состояний
ED (epitaxial deposition) эпитаксиальное нанесение	EDP (ethylene diamine pyrocatechol) этилендиаминпирокатехин
E/D (enhancement/depletion) режим обогащения/обеднения	EDP (electron diffraction pattern) электронограмма
EDB (electrodless direct bounding) безвыводный прямой доступ	EDS (energy dispersive spectroscopy) энергодисперсионная спектроскопия
EDC (energy distribution curves) кривые энергетического распределения	EDT (electron display tube) индикаторная ЭЛТ
E/D CMOS (enhancement/depletion) CMOS КМОП структура в режиме обогащения/обеднения	EDX(A) (energy dispersive X-ray analysis) энергодисперсионный рентгеновский анализ
EDD (electron discharge device) электровакuumный прибор	EDXRF (energy-dispersive X-ray fluorescence) энергодисперсионная рентгеновская флуоресцентная /спектроскопия/
EDFF (edge-defined film-fed) см. EFG	E/E CMOS (enhancement/enhancement) CMOS КМОП структура в режиме обогащения/обогащения
E/D MOSFET (enhancement/depletion) MOSFET МОП транзистор, работающий в режиме обогащения/обеднения	EED (emitter edge dislocations) дислокации на границе эмиттера

- EED (electron energy distribution)
энергетическое распределение электронов
- EE (electron emission)
электронная эмиссия
- EE (exoelectron emission)
экзоэлектронная эмиссия
- EE (edge effect)
краевой эффект
- EEDF (electron energy distribution function)
функция энергетического распределения электронов
- EEIC (elevated electrodes IC)
ИС с приподнятыми электродами
- EELD (edge emission laser diode)
лазерный диод, излучающий с торца
- EELED (edge emission LED)
светодиод, излучающий с торца
- EEM (emission electron microscope)
эмиссионный электронный микроскоп
- EF (evaporated film)
напыленная пленка
- E-FET (enhanced FIT)
ПТ в режиме обогащения
- EFG (electron field gradient)
градиент электрического поля
- EFG (edge-defined film-fed growth)
выращивание ленточного кремния с использованием формообразователя с капиллярной щелью /модификация метода Степанова/ см. также EDFD
- EFZ (encapsulation floating zone)
зонная плавка с жидкостной герметизацией
- EG (electron gun)
электронная пушка
- EGS (epitaxially grown silicon)
эпитаксиальный кремний
- EHD (electron-hole droplets)
электронно-дырочные капли
- EHD-ion source (electrohydrodynamic ion source)
электрогидродинамический ионный источник
- E-HEMT (enhancement-mode HEMT)
транзистор с высокой подвижностью электронов в режиме обогащения
- EHL (electron-hole liquid)
электронно-дырочная жидкость
- ENP (electron-hole pair)
электронно-дырочная пара
- ENP (electron-hole plasma)
электронно-дырочная плазма

EI (end injection)	EL (electroluminescence)
краевая инжекция	электролюминесценция
EIA (extended-interaction amplifier)	EL (electron-trap label)
СВЧ усилитель с протяженным взаимодействием	обозначение электронной ловушки /EL 2 - основной глубокий донорный уровень в нелегированном GaAs /
EID (electron induced (impact) desorption)	ELA (electron linear accelerator)
электроностимулированная десорбция	линейный ускоритель электронов
EIES (electron impact emission spectroscopy)	ELAC (electroacoustic)
эмиссионная спектроскопия при электронном возбуждении	электроакустический
EIK (extended-interaction klystron)	ELC (electroluminescent chamber)
клизотрон с протяженным взаимодействием	электролюминесцентная /ионизационная/ камера
EIL (electron-injection laser)	ELEED (elastic low energy electron diffraction)
электронно-инжекционный лазер	дифракция медленных упруго отраженных электронов
EIMS (electron impact mass-spectrometry)	ELD (electroluminescent display)
масс-спектрометрия электроностимулированной десорбции	электролюминесцентный индикатор
EIO (extended-interaction oscillator)	ELIC (electrophotographic light-scanned image converter)
СВЧ генератор с протяженным взаимодействием	электрофотографический преобразователь изображения с оптическим сканированием
EISS (elastic ion scattering spectroscopy)	ELIN (electronic lamp ion noise)
спектроскопия упругого рассеяния ионов	ионный шум электронной лампы

ELIPS (electron image projection system)
система электронно-лучевого экспонирования

ELO (epitaxial lateral overgrowth)
боковое эпитаксиальное наращивание /разрашивание/

ELSION (electroluminescent-layer sandwich image converter)
твердотельный преобразователь изображения /ТПИ/ с электролюминесцентным слоем

EM (electron microscope, electron microscope)
электронный микроскоп, электронная микроскопия

EM (electron mobility)
подвижность электронов

EMAT (electromagnetic-acoustic transducer)
преобразователь акустических колебаний в электромагнитные

EMBH (etched-mesa buried heterostructure)
скрытая мезаполосковая гетероструктура, полученная химическим травлением

EMDA (ellipsoidal mirror display-type analyzer)
эллипсоидальный зеркальный энергоанализатор с выходом на дисплей

EMIS (electromagnetic isotope separator)
электромагнитный разделитель изотопов

EML (embedded-mirror semiconductor laser)
полупроводниковый лазер со встроенным зеркалом см. также EMS

EMM (electron mirror microscope)
зеркальный электронный микроскоп см. также MEM

EMMA (electron mask making apparatus)
аппаратура для электронно-лучевого изготовления масок

EMMA (electron microscope and microanalysis)
электронная микроскопия и микроанализ

EMP (electromagnetic pulse)
импульс электромагнитного излучения

EMP (electron microprobe)
электронный микрозонд

EMS (embedded-mirror semiconductor) laser
см. EML

EMSD (evaporated metal-semiconductor diode)
диод Шоттки с напыленным слоем металла

EMT (electron multiplier tube)
электронный умножитель

EOLM (electrooptical light modulator)	EPM (electron probe microanalysis)
электрооптический модулятор света	электронно-зондовый микроанализ
EOM (electro-optic modulator)	EPS (electrochemical photocapacitance spectroscopy)
электрооптический модулятор	электрохимическая фото-емкостная спектроскопия
EOS (electrical overstress)	EPT (epitaxial planar transistor)
перенапряжение	эпитаксиальный планарный транзистор
EP (etch pit)	EQE (external quantum efficiency)
ямка травления	внешняя квантовая эффективность
EP (epitaxial planar) эпитаксиальная планарная структура	ER (electroreflectance)
EPD (etch pit density)	электроотражение
плотность ямок травления /мера плотности дислокаций/	ER (explosive recrystallization)
EPD (electrode pattern definition)	взрывная рекристаллизация
формирование рисунка электродов	ER (electron resist)
EPD (electro-phoretic display)	электронорезист
электрофорезный индикатор	ER (exposing radiation)
EPIC (etched polycrystalline-carried IC)	экспонирующее излучение
изоляция ИС с помощью поликремния в вытравленной канавке	ERD (elastic recoil detection)
EPL (electron projection lithography)	спектроскопия атомов отдачи /при упругих соударениях быстрых ионов/
проекционная электронолитография	ERM (evaporate rate monitor)
	регулятор скорости напыления
	ERW (etched ridge waveguide)
	вытравленный реберный волновод

- ES (electron spectroscopy)
электронная спектроскопия
- ES (emission spectroscopy)
эмиссионная спектроскопия
- ESA (electron-stimulated adsorption)
электроностимулированная адсорбция
- ESA (electrostatic analyser)
электростатический энергоанализатор
- ESBI (equivalent screen background input)
входной сигнал, эквивалентный фоновому свечению экрана /в ЭОП/
- ESD (electrostatic damage)
электростатическое повреждение
- ESD (electrostatic discharge)
электростатический разряд
- ESDI (electron stimulated desorption of ions)
электроностимулированная десорбция ионов
- ESDIAD (electron stimulated desorption of ions, angular distribution)
угловое распределение электроностимулированной десорбции ионов
- ESEM (environmental scanning electron microscope)
растровый электронный микроскоп, могущий работать в условиях повышенного давления или влажности
- ESF (electrostatic focusing)
электростатическая фокусировка
- ESFK (electrostatically focused klystron)
клистрон с электростатической фокусировкой
- ESGL (embedded stripe geometry laser)
лазер со встроенной полосковой геометрией
- ESI (electron spectroscopic imaging)
отображение электронных спектров
- ESP (edge-supported-pulling) process
метод вытягивания с фиксированными краями
- ESR-Si (edge-stabilized ribbon-Si)
ленточный кремний, полученный методом Степанова /профилированием с использованием формователя/
- ESS (electronic scanning system)
система электронного сканирования

ESST (electrical signal storage tube)

запоминающая ЭЛТ с электрическими входным и выходным сигналами

ESURF (electron-beam surface heating)

электронно-лучевой нагрев поверхности

ET (electronic tube)

электронная лампа

ETFT (enhancement-mode TFT)

тонкопленочный транзистор в режиме обогащения

ETT (electrically triggered thyristor)

электрически управляемый тиристор

EUV (edge ultra-violet)

краевое УФ излучение

EUV (extreme UV)

излучение на границе УФ и рентгеновского диапазонов /~ 20 нм/

EXELFS (extended energy loss fine structure)

протяженная тонкая структура в спектрах потерь энергии электронов

F

FAB-sputtering (fast atom bombardement (beam) sputtering)

распыление /мишени/ пучком быстрых атомов

FAIE (field assisted internal emission) внутренняя эмиссия, усиливаемая полем

FAL (flat active layer)

плоская активная область

FAST (fixed abrasive slicing technique) метод разрезания фиксированным абразивом

FB (flat band)

плоская зона /"напряжение плоских зон" в методе вольт-фарадных характеристик/

FB (film bolometer)

пленочный болометр

FBEM (fixed-beam transmission electron microscope)

просвечивающий электронный микроскоп с фиксированным лучом /режим, обеспечивающий высокое разрешение/

FBK (finite beam klystron)

клинотрон с конечным пучком

FC (flip-chip)

метод обратного /перевернутого/ монтажа

FC (ferroelectric carrier)

сегнетоэлектрический носитель

FCA (film carrier assembly)

сборка бескорпусных ИС на ленте-носителе

FCAT (floating-gate channel corner avalanche transistor)
полевой транзистор с плавающим затвором и лавинной инжекцией через угловые участки канала

FCC (face-centered cubic)
гранцентрированная кубическая /ГЦК/ решетка

FDMS (flash desorption mass-spectrometry)
масс-спектрометрия вспышечной десорбции

FDS (flash desorption spectroscopy)
спектроскопия вспышечной десорбции

FDS (field desorption spectroscopy)
спектроскопия полевой десорбции

FDTK (floating-drift-tube klystron)
клистрон с плавающим потенциалом трубки дрейфа

FE (flash evaporation)
метод взрывного испарения

FE (field emission)
автоэлектронная эмиссия

FE (ferroelectric)
сегнетоэлектрик

FEC (field emission cathode)
автоэмиссионный катод

FED (field emission deposition)
осаждение пленок с использованием автоионного распылителя /жидкометаллического источника ионов/

FED (ferroelectric display)
сегнетоэлектрический индикатор

FEE (field electron emission)
автоэлектронная эмиссия

FEED (field emitted electron distribution)
энергетическое распределение автоэлектронов

FEEM (field-electron emission microscope)
автоэмиссионный электронный микроскоп

FEFED (ferrielectric field effect device)
сегнетоэлектрический полевой прибор

FEG (field emission gun)
электронная пушка с автоэмиссионным катодом

FEL (free electron laser)
лазер на свободных электронах /ЛСЭ/
см. также ОК

FEM (field electron microscope)
автоэмиссионный электронный микроскоп

- FERP (field emission retarding potential) methode
метод задерживающего потенциала для автоэмиссионного тока /метод измерения работы выхода/
- FES (field emission spectroscopy)
автоэмиссионная спектроскопия
- FESE (field enhanced secondary emission)
см. FESEE
- FESEE (field enhanced secondary electron emission)
усиленная полем вторично-электронная эмиссия
см. также FSSEE, FESE
- FETDS (field emission thermal desorption spectroscopy)
автоэмиссионная термодесорбционная спектроскопия
- FETT (field effect tetrode transistor)
полевой тетрод
- FF (fill factor)
коэффициент заполнения ВАР /солнечных элементов/
- F²R (fully-framed-fully recessed)
изоляция полностью заглубленным слоем внутри рамки
- FG (floating gate)
плавающий затвор /затвор с плавающим потенциалом/
- FIB (focused ion beam)
сфокусированный ионный пучок
- FIJ (field induced junction)
индуцированный полем переход
- FIM (field ion microscope)
автоэмиссионный ионный микроскоп
- FIM (focused ion milling)
фрезерование сфокусированным ионным пучком /ионно-лучевое фрезерование/
- FIR (frustrated internal reflection)
нарушенное полное внутреннее отражение
- FL (Fermi level)
уровень Ферми
- FLA (flash lamp annealing)
импульсный отжиг /от лампы-вспышки/
- FLAD (fluorescent activated display)
индикатор с люминесцентной подсветкой
- FLE (Fermi level energy)
энергия Ферми
- FLIR (forward-looking IR)
ИК-система передачи обзора /ИК-СПО/ в переднюю полусферу

FLL (fine line lithography)
прецизионная литография

FLP (flat-pack package)
плоский корпус МС с горизонтальным расположением выводов

FLR (field-limiting ring)
кольцевое ограничение поля в целях повышения напряжения пробоя

FLT (fine leak tester)
высокочувствительный течеискатель

FM (frequency-modulated)
частотно-модулированный

FMOS (floating-gate MOS)
МОП ПТ с плавающим затвором

F-N-curve (Fowler-Nordheim curve)
характеристика Фаулера-Нордгейма

FORR (fibre-optic ring resonator)
кольцевой волоконно-оптический резонатор

FOV (field of view)
поле зрения /обзора/

FPA (focal plane array)
матричный приемник изображения в фокальной плоскости /фокальная матрица/

FP-cavity (Fabry-Perot cavity)
оптический резонатор Фабри-Перо

FPD (flat panel display)
плоская индикаторная панель

FPP (flat plastic package)
плоский пластиковый корпус

FRED (fast recovery epitaxial diode)
эпитаксиальный диод с быстрым восстановлением

FREDFET (fast-recovery reverse diode FET)
мощный МОП ПТ с обратносмещенным диодом с быстрым восстановлением

FRS (frequency-resolved spectroscopy)
спектроскопия с частотным разрешением

FSCL-current (fully-space-charge limited current)
ток, полностью ограниченный пространственным зарядом

FSD (flat screen display)
дисплей с плоским экраном

FSE (funnel-shaped electrode)
воронкообразный /конусный/ электрод

FSF (front-surface field)
поле, встроенное у фронтальной поверхности /солнечного элемента/

FSH (funnel-shape hole) коническое отверстие в апертурной маске	FTD (fast turn-on diode) диод с быстрым переключением
FSS (fast surface states) быстрые поверхностные состояния	FTFET (four-terminal FET) полевой тетрод
FSSEE (field stimulated secondary electron emission) см. FESEE	FTIR (Fourier-transform IR-spectroscopy) ИК Фурье-спектроскопия
FSST (flying spot scanning tube) ЭЛТ со сканированием бегущим лучом	FTL (fully temperature limited) /катод/ в режиме насыщения эмиссионного тока
FST (fast switching thyristor) тиристор с быстрым переключением	FTM (film thickness monitor) измеритель толщины пленки
FT (frame transfer imager) твердотельный преобразователь изображения с кадровым переносом	FT-MS (Fourier-transform mass-spectrometry) масс-спектрометрия с фурье-преобразованием сигнала
FT (fluorescent target) люминесцентная мишень	FTS (Fourier transform spectroscopy) фурье-спектроскопия
FTC (film-type circuit) пленочная микросхема	Full-Rox (full-recessed oxide) полностью заглубленный слой оксида
FT CCD (frame transfer CCD) ПЗС-преобразователь изображения с покадровым переносом	FWT (fast wave tube) СВЧ лампа на быстрых волнах
FTD (field-terminated diode) диод на подложке, используемой для создания требуемой конфигурации электрического поля	FX (fluorescent X-ray analysis) рентгеновский флуоресцентный анализ /РФА/

G

GATO (gate-assisted turn-off thyristor)
см. GTO

GATT (gate-assisted turn-off thyristor)
см. GTO

GAV (gallium arsenide varactor)
варактор на арсениде галлия

GB (grain boundaries)
границы зерен /в поликристаллическом материала/

GB (gate bias)
смещение затвора

GBD (grain boundary dislocation)
дислокации на границах зерен поликристаллического материала

GBP (gain-bandwidth product)
произведение усиления на ширину полосы

GB-SQW (graded barrier single quantum well)
одиночная квантовая яма с варизонным барьерным слоем

GBT (graded-base transistor)
дрейфовый транзистор с градиентом концентрации примеси в области базы

GBWO (gyro-BWO)
лампа обратной волны гиروتронного типа /гиrolов/

GC (growth of crystal)
выращивание монокристалла

GCD (gate controlled diode)
диод с управляющим затвором

GCS (gate controlled switch)
переключатель с управляющим электродом

GCS (gate controlled silicon rectifier)
кремниевый тиристор

GCSP (guide channeled-substrate planar) laser
лазерный диод с волноводной планарной структурой с каналом в подложке

GD-a-Si (glow discharge a-Si)
аморфный кремний, полученный разложением силана в тлеющем разряде

GDC (graphics display controller)
контроллер графического дисплея

GDD (gas discharge device)
газоразрядный прибор /ГРП/
см. также GT (gas tube)

GDDE (gradually-doped source-drain extension)
промежуток исток-сток, ле-

гированный с градиентом концентрации примеси

GDL (gas discharge laser)
газоразрядный лазер

GDI (glow discharge indicator)

индикаторная лампа тлеющего разряда

GDMS (glow discharge mass-spectrometry)
масс-спектрометрия тлеющего разряда

GDOS (glow discharge optical spectroscopy)
оптическая спектроскопия тлеющего разряда

GDT (gas-discharge tube)
газоразрядная трубка

GDT (glow discharge tube)
лампа тлеющего разряда см. также GT (glow tube)

GDT (grown-diffused transistor)
выращенный диффузионный транзистор

GED (Gunn-effect diode)
диод Ганна

GEMFET (gain enhanced MOS FET)
МОП ПТ с повышенным усилением

GET (germanium transistor)
германиевый транзистор

GF (gradient freeze)
направленная кристаллиза-

ция с изменением градиента температуры

GFIS (gaseous field ion source)
ионный источник с полем вытягиванием ионов из газовой среды

GFR (gas-filled rectifier)
газотрон

GRT (gas-fielled triode)
тиратрон

GFT (gas-filled tube)
газонаполненная лампа

GGC (global geometrical checking)
глобальная геометрическая проверка топологического чертежа ИС

GGG (gadolinium-gallium garnet)
гадолиний-галлиевый гранат

GGO MOSFET (graded gate oxide MOSFET)
МОП ПТ с градиентом толщины подзатворного окисла вблизи края поликремниевго затвора

GGPM (grid-gated photomultiplier)
ФЭУ с сеточным затвором

GH type LCD (guest-host type LCD)
жидкокристаллический индикатор на эффекте "гость-хозяин"

GI (graded index)
см. GRIN

GIF (graded index fibre)	GMSD (galvanomagnetic semiconductor device)
стекловолокно с переменным показателем преломления	гальваномангнитный полупроводниковый прибор /датчик Холла/
GIG (gadolinium iron garnet)	GO (gate oxide)
железо-гадолиниевый гранат	подзатворный окисел
GILD (gas immersion laser diffusion)	GOT (gyromonotron oscillator tube)
диффузия из газовой фазы, стимулированная лазерным излучением	гиромонотрон
GIMIS (graded energy-band-gap insulator MIS)	GPE (gas plasma etching)
МДП структура с варизонным диэлектриком	газоплазменное травление
GIP (getter-ion pump)	GR (guard ring)
геттерно-ионный насос	охранное кольцо /в ЛФД/
GJ (grown junction)	GR (growth rate)
выращенный переход	скорость роста /кристалла/
GJT (germanium junction transistor)	G-R (generation-recombination)
германиевый планарный транзистор	процесс генерации-рекомбинации
GJT (grown-junction transistor)	GRAPD (guard-ring avalanche photodiode)
транзистор с выращенным переходом	лавинный фотодиод с охранным кольцом
GL (gas laser)	GRECC (graded-index-rod external-coupled cavity)
газовый лазер	внешний связанный резонатор с градиентом показателя преломления в волноводной области
GL (grid leak)	GREG (gradient recrystallization and growth)
сопротивление цепи управляющей сетки	градиентная рекристаллизация и выращивание
GM (Geiger-Müller counter)	GRIN (graded index)
счетчик Гейгера-Мюллера	постепенно изменяющийся

показатель преломления /градиент показателя преломления/
см. также GI

GRN (generation-recombination noise)
генерационно-рекомбинационный шум

GRP (glass reinforced plastic)
корпус из армированной стеклом пластмассы

GRS (gamma-ray spectroscopy)
гамма-спектроскопия

GSMBE (gas source molecular-beam epitaxy)
молекулярно-лучевая эпитаксия с газообразным источником

GSO (gadolinium orthosilicate)
ортосиликат гадолиния /осцинтиллятор/

GSPC (gas scintillation proportional counter)
газовый сцинтилляционный пропорциональный счетчик

GSV (gate-source voltage)
напряжение затвор-исток

GT (glow tube)
см. GDT

GT (gas tube)
см. GDD

GT (gas-tight)
газонепроницаемый

GICR (gate-turn-off controlled rectifier)
см. GTO

GTO (gate turn-off thyristor)
запираемый тиристор с выключением по цепи управляющего электрода
см. также GATO, GATT, GTCR

GIWT (gyro-TWT)
лампа бегущей волны гиротронного типа /гирос-ЛБВ/

GUT (gate underlaid transistor)
транзистор с затвором на изолирующей подложке

GXR (grazing X-ray reflection)
/метод/ отражения скользящего рентгеновского излучения

Н

HCNOS (hybrid complementary MOS)
гибридная КМОП структура /комбинация E/D CMOS и E/E CMOS/
см. также CHMOS

HAPD (heterostructure APD)
лавинный фотодиод с гетероструктурой

NB (heavy-hole band)
зона тяжелых дырок

NB (horizontal Bridgeman)
горизонтальный метод Бриджмена

HBT (heterojunction bipolar transistor)
биополярный транзистор с гетеропереходом

HC (hollow cathode)
полый катод

HC (hyperconductivity)
сверхпроводимость

HCDST (high contrast display storage tube)
запоминающая индикаторная ЭЛТ с высоким контрастом

HCL (hollow cathode laser)
лазер с полым катодом

HCP (heterojunction-contact photoconductor)
фоторезистор с гетеропереходом в области контакта /с простойкой из более широкозонного материала между металлическим контактом и полупроводником/

HDCT (high density circuit technique)
технология ИС с высокой плотностью элементов

HE (heteroepitaxy)
гетероэпитаксия

HE (Hall effect)
эффект Холла

HE (hot electron)
горячий электрон

HE (high efficiency)
высокая эффективность /высокий к.п.д./

HEAPS (high-energy electron APS)
спектроскопия потенциала

появления быстрых электронов

HEIB (high energy ion beam)
пучок ионов высокой энергии

HEL (high-energy laser)
мощный лазер

HELIOS (hot-electron-layer ion source)
ионный источник со слоем горячих электронов /на основе электронного циклотронного резонанса/

HEM (heat exchanger method)
метод теплообменника

HEMOS (hot electron MOS)
МОП структура с разогретым электроном

HEMT (high electron mobility transistor)
транзистор с высокой подвижностью электронов

HEM-W (hybrid electromagnetic wave)
гибридная электромагнитная волна

HES (heteroepitaxial system)
гетероэпитаксиальная система

HET (hot electron transistor)
транзистор на горячих электронах

HFO (high-frequency oscillations)
высокочастотные колебания

HFPA (hibrid focal-plane array)
гибридная фокальная матрица /приемник изображения/

HFPP (high-field pulsed plating)
осаждение покрытий в сильном импульсном электрическом поле

HFS (hyperfine structure)
сверхтонкая структура

HFVBiG (high-focus-voltage bipotential gun)
бипотенциальная электронная пушка с высоким фокусирующим напряжением

HF/VPE (hydrogen fluoride vapour-phase etching)
травление в парах HF

HGF (horisontal gradient freeze)
метод кристаллизации в горизонтальном градиенте температуры

HIB (heavy-ion beam)
пучок тяжелых ионов

HICAT (high-capacitance trench)
структура с разделительными канавками высокой емкости /для СВИС/

Hi-CMOS (Hitachi CMOS)
КМОП ИС фирмы Hitachi

HI/LO-resist (high-low-sensitivity resist)
система двухслойного резиста с высокой-низкой чувствительностью

Hi-Lo (high-low)
см. HI-LO

HI-LO (high-low)
переход в виде сильнолегированного слоя на слаболегированной подложке

HI-LO SAM APD (high low SAM APD)
ЛФД с разделением областей поглощения и умножения со ступенчатым уровнем легирования в области лавинного умножения

HiMOS (MNOS) (high-performance MOS (MNOS))
высококачественная МОП /МНОП/ структура

HIRBS (heavy-ion RBS)
спектроскопия обратного резерфордского рассеяния тяжелых ионов

HISSDAY (high-speed semiconductor device analysis)
экспресс-анализ полупроводниковых приборов

HIT (high density integration) technology)
технология БИС с высокой плотностью элементов

HITT (heterojunction integrated transit-time)
интегральный лавинно-пролетный гетеродиод

- HJSC (heterojunction solar cell)
солнечный элемент с гетеропереходом
- HL (high-low)
см. HI-LO
- HL (hole-trap label)
обозначение дырочной ловушки
- HLE (high-low emitter)
изотипный эмиттерный переход
- HLJ (high-low junction)
изотипный переход между слоями с различной степенью легирования /n⁺ p или p⁺ p/
- HM (half mirror)
полупрозрачное зеркало
- HMOS (horizontal switching MOS)
ключевой МОП ПТ с горизонтальной структурой
- НМОСCVD (homogeneous CVD)
однородное /равномерное/ химическое осаждение из паровой фазы
- HORDIS (hot reflex discharge ion source)
сильноточный ионный источник на основе отражательного разряда с накаливаемым катодом
- HP (high pressure)
высокое давление
- HP-Ge, Si (high purity Ge, Si)
Ge, Si высокой чистоты
- HPL (holographic photolithography)
голографическая фотолитография
- HPT (heterojunction phototransistor)
фототранзистор с гетеропереходом
- HR (high resolution)
высокое разрешение
- HREELS (high-resolution electron energy loss spectroscopy)
спектроскопия потерь энергии электронов с высоким разрешением
см. также HRELS
- HRELS (high resolution electron loss spectroscopy)
см. HREELS
- HREM (high-resolution electron microscopy)
электронная микроскопия с высоким разрешением
- HRIR (high resolution IR)
ИК-система с высоким разрешением
- HRLC (high reliability low cost) IC
дешевая ИС высокой надежности /высокая надежность при низкой стоимости/
- HRO (heteroepitaxial ridge-overgrown)
гетероэпитаксиальный /лазерный диод/ с реберным контактом поверх изолирующего слоя

HRT (hard-ray tube)
источник жесткого рентгеновского излучения

HRXT (high-rating X-ray tube)
мощная рентгеновская трубка

HSC²MOS (high-speed clocked complementary MOS)
быстродействующая синхронизованная КМОП ИС

HSJ (half-sided junction)
модель поверхности с обедненным слоем, рассматриваемой как половина перехода

HSP (heat-sinking package)
корпус с теплоотводом

HSP (hermetically sealed package)
герметизированный корпус

HSRSS (high-speed raster-scan system)
быстродействующая растровая сканирующая система

HSS (high-speed scanning)
высокая скорость сканирования

HSZD (hermetically sealed Zener diode)
герметизированный стабилитрон

HT (heterostructure transistor)
гетеротранзистор
HT-annealing (high temperature annealing)
высокотемпературный отжиг

HTCVD (high temperature CVD)
высокотемпературный процесс химического осаждения из паровой фазы

HVEE (high voltage electron exposure)
высоковольтная система электронного экспонирования

HVS (high vacuum system)
высоковакуумная система

HVSEM (high-voltage scanning electron microscope)
высоковольтный растровый электронный микроскоп

HVT (high voltage tube)
высоковольтная трубка

HWE (hot wall epitaxy)
эпитаксия методом горячей стенки

HWE (hot-wall evaporation)
напыление пленок методом горячей стенки

HWF (hot-wall-flash)
метод мгновенного испарения в условиях горячей стенки
см. также HWFE

HWFT (hot-wall flash evaporation)
см. HWF

HX (heat exchanger)
теплообменник

I

IA (image amplifier)
усилитель изображения

IA (image array)
матричный преобразователь
изображения

IAD (ion-assisted
deposition)
термическое напыление с
одновременным ионным об-
лучением
см. также IVD

IAES (ion-induced
AES)
электронная оже-спектро-
скопия с ионным возбуж-
дением

IAL (inclined active
layer)
наклонная активная об-
ласть

IAO (ion angular
distribution)
угловое распределение
ионов /при электроноستي-
мулированной десорбции/

IAT (ion-accelerator
tube)
ионный ускоритель

IB (ion beam)
ионный пучок

IBAE (ion beam
assisted etching)
ионно-лучевое /безмасоч-
ное/ травление

IBB (ideal black
body)
абсолютно черное тело

J

JBS-rectifier (junction-
barrier-controlled
Schottky rectifier)
тиристор с управляющим
барьером Шоттки

JMOS (joint MOS)
ИС на n- и p-канальных
МОП ПТ с соединенными
затворами

JCMOS (CMOS-transistor
with junction gate)
КМОП ПТ с управляющим пе-
реходом

JCMOS (joint-gate
CMOS)
КМОП структура с объеди-
ненным затвором /с само-
совмещением истока и сто-
ка обоих транзисторов с
электродом объединенного
затвора/

JMA (Josephson memory
array)
матричное ЗУ на эффекте
Джозефсона

JMOS (junction-MOS)
МОП транзистор с управ-
ляющим переходом

JPT (junction photo-
transistor)
плоскостной фототранзи-
стор, биполярный фото-
транзистор/

JUFET (junction-gate
FET)
ПТ с управляющим пере-
ходом

IBC (interdigitated back contact)
встречно-штыревой тыловой контакт /солнечного элемента/

IBC (ion beam coating)
покрытие, полученное ионно-лучевым методом

IBCFA (injected beam crossed field amplifier)
усилительная электронная лампа СВЧ со скрещенными полями с инжектированным пучком

IBD (ion-beam device)
ионно-лучевой прибор

IBD (ion beam deposition)
ионно-лучевое нанесение /пленок/

IBDD (ion-beam direct deposition)
прямое ионно-лучевое нанесение

IBED (ion-beam enhanced deposition)
осаждение с ионно-лучевой стимуляцией

IBEE (ion-beam enhanced etching)
усиленное ионным облучением травление

IBESE (ion bombardment enhanced selective etching)

усиленное ионной бомбардировкой селективное травление

IBI (ion-beam implantation)
ионная имплантация

IBI (ion beam induced)
образованный под действием ионной бомбардировки

IBIE (ion-beam inhibited etching)
ослабленное ионным облучением травление

IB-MOS (ion beam MOS)
МОП структура, полученная методом ионной имплантации

IBS (ion backscattering spectroscopy)
спектроскопия обратнорассеянных ионов /ионно-рассеивательная спектроскопия/

IBS (ion beam sputtering)
ионно-лучевое распыление

IBSCA (ion beam spectro-chemical analysis)
ионно-лучевой спектроскопический анализ

IBSD (ion-beam sputter deposition)
нанесение /пленок/ методом ионно-лучевого распыления

IBSM (ion-beam scanning method)
метод ионно-лучевого сканирования

IBSM (ion-beam sputter etching or machining)
травление или формование методом ионно-лучевого распыления

IBT (intrinsic-barrier transistor)
транзистор с внутренним барьером

IC (image converter)
преобразователь изображения

IC (ionization chamber)
ионизационная камера

ICA (integrated circuit analyzer)
анализатор интегральных микросхем

ICB (IC breadboard)
макет ИС

ICB (ionized cluster beam)
пучок ионизированных кластеров

ICC (internal conversion coefficient)
коэффициент внутренней конверсии

ICES (internal conversion electron spectroscopy)
спектроскопия электронов внутренней конверсии

ICF (IC family)
семейство ИС

ICID (intensified charge injection device)
ПЗИ с повышенным уровнем инъекции

ICIG (integrated coherent infrared generator)
интегральный источник когерентного ИК излучения

ICISS (impact-collision ion scattering spectroscopy)
ионно-рассеивательная спектроскопия в режиме ударных столкновений

ICL (IC layout)
размещение элементов на ИС

ICP (IC package)
корпус интегральной микросхемы, интегральный модуль

ICR (ion cyclotron resonance)
ионный циклотронный резонанс

ICRH (ion cyclotron resonance heating)
разогрев /плазмы/ методом ионного циклотронного резонанса

ICRF (ion cyclotron range of frequencies)
частотный диапазон ионного циклотронного резонанса

ICT (image converter tube)
электронно-оптический преобразователь изображений /ЭОП/

ICT (IC technology)
технология ИС

IC TMP (IC tri-metal processing)
технология ИС с трехуровневой металлизацией

ICTS (IC test system)
система проверки ИС

ICTS (isothermal capacitance transient spectroscopy)
изотермическая емкостная нестационарная спектроскопия /глубоких уровней/

ICVD (ion beam CVD)
ионно-лучевое осаждение из паровой фазы

ID (image device)
преобразователь изображения

ID (interconnection diagram)
схема межсоединений /ИС/

ID (inversed diode)
обращенный диод

IDC (image dissector camera)
диссектор

IDC (impregnated dispenser cathode)
распределительный импрегнированный катод

IDCCC (integrated decoupling capacitor chip carrier)
кристаллоноситель с интегральным развязывающим конденсатором

IDU (indicator drive unit)
блок возбуждения индикатора

IE (infrared emission)
ИК излучение

IED (ion energy distribution)
энергетическое распределение ионов

IEE (ion-induced electron emission)
ионно-электронная эмиссия

IEI (integrated etalon interference) laser
эталонный лазер со встроенным интерферометром

IEMM (incidence energy modulation method)
метод модуляции падающего излучения

IES (ion-electron spectroscopy)
ионно-электронная спектроскопия

IET(S) (inelastic electron tunneling spectroscopy)
спектроскопия неупругого квантово-механического туннелирования электронов

IFA (infrared flash annealing)
импульсный ИК отжиг

I-F-T-emission (ion-field-thermoelectron emission)
ионно-электронная автотермоэмиссия /в плазму при дуговом разряде/

IGP (ion getter pump)
ионно-сорбционный насос

IGR (insulated-gate rectifier)
тиристор с изолированным затвором

IGT (insulated-gate transistor)
ПГ с изолированным затвором

INC (indirectly heated cathode)
катод косвенного накала

IID (ion induced desorption)
десорбция, индуцированная ионной бомбардировкой

IID (ion-implanted device)
прибор, изготовленный методом ионной имплантации

IIJ (ion-implanted junction)
переход, полученный методом ионной имплантации

II-PLASA (ion-implanted planar-mesa)
меза-планарная технология в сочетании с ионной имплантацией

IIR (ion-impact induced radiation)
излучение, индуцированное ионной бомбардировкой

IIR (intermediate IR)
излучение в средней части ИК диапазона

IIR (ion-implanted region)
ионно-легируемая область

III (image intensifier tube)
усилитель яркости изображения

IIXE (ion-induced X-ray emission)

/спектроскопия/ ионно-индуцированного рентгеновского излучения

IL (inversion layer)
инверсионный слой /с переменной типа проводимости/

IL (ion laser)
ионный лазер

IL (indicating lamp)
индикаторная лампа

IL CCD (interline transfer CCD-imager)
см. ITCCD

ILD (injection laser diode)
инжекционный лазерный диод

ILS (ionization loss spectroscopy)
спектроскопия ионизационных потерь

IM (ion milling)
ионное фрезерование

IMFP (inelastic mean free path)
средняя длина пробега для неупругих взаимодействий

IMMA (ion microprobe mass-analyser)
ионный микрозондовый масс-анализатор

I-MOS (induced inversion layer MOS)
МОП структура с индуцированным инверсионным слоем

IMOX (ion-implanted oxide-isolation process) технология ИС с использованием ионной имплантации и боковой изоляции окислом

IMP (integrated microwave package) интегральный СВЧ модуль

IMP A (ion microprobe analysis) ионный микроанализ /анализ поверхности с помощью ионного микронзонда/

IMS (ion-mobility spectroscopy) спектроскопия подвижности ионов

INMS (ionized neutral mass-spectrometry) масс-спектрометрия ионизированных атомов

INS (ion-neutralization spectroscopy) ионно-нейтрализационная спектроскопия

INWATE (integrated waveguide technology) технология интегрированных волноводов

IO (image orthicon) суперортикон

IOC (intercell ohmic contact) межэлементный омический контакт /в каскадных солнечных элементах/

IOEC (integrated optoelectronic circuit) оптоэлектронная интегральная микросхема

IOP (isolation by oxide and polysilicon) изоляция оксидом и поликремнием

IP (ion plating) ионное нанесение покрытий

IPAT (ion plating and allied techniques) ионное нанесение покрытий и связанная с ним технология

IPC (imperfection photoconductivity) примесная фотопроводимость

IPE (inverse photoemission) spectroscopy см. IPES

IPES (inverse photoemission spectroscopy) обращенная фотоэмиссионная спектроскопия /спектроскопия изохроматического тормозного УФ излучения, электрон-фотонная спектроскопия/ см. также IPE, BIS, UBIS

IPhPE (impurity photo-plastic effect) примесный фотомеханический эффект

IPL (ion projection lithography) ионная проекционная литография

IPS (ion-induced photon emission spectroscopy) ионно-фотонная спектроскопия /ИФС/

IPS (ion projection system)
ионный прожектор /ионная пушка/

IQE (internal quantum efficiency)
внутренняя квантовая эффективность

IRAM (integrated RAM)
ЗУПВ в интегральном исполнении

IRCID (IR-charge injection device)
приемник ИК-изображения на ПЗИ

IRCON (IR-detector)
приемник ИК излучения /в том числе пирометр/

IREB (intense relativistic electron beam)
интенсивный релятивистский электронный пучок

IRI (internal reflection interference) laser
лазерный диод с внутренней интерференцией

IRQ (IR-quenching)
ИК-гашение какого-либо эффекта ИК облучением/

IRQC (IR quantum counter)
счетчик фотонов, чувствительный в ИК области спектра

IRRS (IR reflection spectroscopy)
спектроскопия отражения ИК излучения

IRS (inter-reflection spectroscopy)
спектроскопия /полного/ внутреннего отражения

IRT (intrinsic region transistor)
транзистор со структурой pnip

IRTA (infrared rapid thermal annealing)
быстрый ИК-термический отжиг

IRW (inverted rib waveguide)
волновод в виде обращенного ребра

IS (ion source)
ионный источник

IS (ionization spectroscopy)
ионизационная спектроскопия

ISL (inverted superlattice)
обращенная сверхрешетка /CP/ /подложка /n⁺/CP/n-/n+)

ISM (insulator-semiconductor-metal)
структура диэлектрик-полупроводник-металл /ДПМ/

ISO (isoplanar)
изопланарная структура, технология /планарная структура с изоляцией окислом/
см. также ISOPLANAR

ISOFET (isolated polysilicon oxide gate FET)
полевой транзистор с поликремниевым затвором и окисной изоляцией

ISO HCMOS (isolated silicon-oxide-gate high-density CMOS)
КМОП ИС с поликремниевыми затворами и окисной изоляцией с высокой плотностью элементов

ISOPLANAR (insulation oxide planar)
изопланарная технология см. ISO

ISOPLANAR-S (ISOPLANAR process with scaling)
изопланарная технология с уменьшением масштаба

ISOVPE (isothermal VPE)
изотермическая парофазная эпитаксия

ISPD (intensified silicon photodiode array)
кремниевая фотодиодная матрица с предусилителями

ISSA (intensified self-scanned array)
самосканирующая матрица с предварительным усилением

IT (interline transfer) CCD
ПЗС с межстрочным /или строчно-кадровым/ переносом

ITC (induced thermocurrent)
индуцированный термоток

ITC (ionic thermocurrent)
ионный термоток

ITCCD (interline transfer CCD-imager)
ПЗС-преобразователь изображения с межстрочным переносом см. также ILCCD

ITDS (isothermal desorption spectroscopy)
изотермическая десорбционная спектроскопия

ITG (integrated twin-guide) laser
лазерный диод со сдвоенным волноводом в интегральном исполнении

ITIC (isothermal transient ionic current)
/метод/ изотермического переходного ионного тока /измерение переходного тока, вызванного подвижными ионами после снятия напряжения/

ITM (implantation through metal)
имплантация через слой металла

ITO (indium-tin oxide)
 $\text{SnO}_2\text{-In}_2\text{O}_3$
окись индия-олова /прозрачный проводящий слой/

ITS (inelastic tunneling spectroscopy)
спектроскопия неупругого туннелирования

ITTD (injection transit-time diode)
инжекционно-пролетный диод

IVD (ion and vapour deposition)

см. IAD

IVPO (inside vapor-phase-oxidation)
внутреннее окисление из паровой фазы под пленкой

IXS (ion-excitation X-ray spectroscopy)
спектроскопия ионно-возбужденного рентгеновского излучения

К

KDP (kalium dihydrogenphosphate KH_2PO_4)
дигидрофосфат калия /КДП/

KLA (klystron amplifier)
клистронный усилитель

KLO (klystron oscillator)
клистронный генератор

KRIPES (k-resolved inverse photoemission spectroscopy)
обращенная фотоэмиссионная спектроскопия с разрешением по тангенциальному моменту K_{\parallel} /зависимость интенсивности монохроматического УФ излучения от угла падения электронного пучка/

L

LA (laser annealing)
лазерный отжиг

LAMMA (laser microprobe mass-analysis)
масс-анализ с лазерным микрозондом

LAS (laser-assisted soldering)
лазерная пайка

LASS (laser-activated semiconductor switch)
полупроводниковый переключатель, управляемый лазером

LATS (luminescence-assisted two-photon spectroscopy)
двухфотонная люминесцентная спектроскопия

LAXS (low angle X-ray scattering)
малоугловое рассеяние рентгеновского излучения

LAZ (laser alloyed zone)
область лазерного легирования

LB (Langmuir-Blodgett)
пленка Лэнгмюра-Блоджетт /пленка органического вещества мономолекулярной толщины/

LBIC (laser-beam induced current)
ток, наведенный лазерным облучением

LBIC (light-beam induced current)
ток, наведенный световым лучем

LB MOS (lateral-merged bipolar MOS)
объединенные по горизон-

тали биполярный транзистор
и МОП ПТ

LBP (laser-beam printer)
лазерное записывающее устройство

LBT (lambda bipolar transistor)
лямбда-биполярный транзистор со специальным профилем концентрации в эмиттерной области

LCAO (linear combination of atom orbitals)
теория /приближение/ линейной комбинации атомных орбиталей /ЛКАО/

LCCC (leadless ceramic chip carrier)
безвыводная керамическая подложка

LCCD (liquid crystal character display)
символьный жидкокристаллический индикатор

LCDD (LCD-driver)
схема возбуждения жидкокристаллического индикатора

LCGD (liquid crystal graphic display)
графический дисплей на жидких кристаллах

LCLV (liquid crystal light valve)
жидкокристаллический световой клапан

LC MOS (long channel MOS)
МОП ПТ с длинным каналом

LCMOS (low-threshold CMOS)
низкопороговый КМОП транзистор

LCRT (laser cathode ray tube)
электронно-лучевая трубка с экраном в виде матрицы полупроводниковых лазеров

LCSW (light-coupled semiconductor switch)
полупроводниковый переключатель с оптической связью

LCVD (laser-assisted induced CVD)
химическое осаждение из паровой фазы с лазерной стимуляцией

LD (laser diode)
лазерный диод

LD (leak detector)
вакуумный течеискатель

LD²MOS (lateral double-diffused MOS)
планарная МОП структура, полученная двойной продольной диффузией

LDMS (laser desorption mass-spectrometry)
масс-спектрометрия продуктов стимулированной лазерным облучением десорбции

LDOS (local density of states)
локальная плотность состояний
см. также LDS

- LDS (local density of states)
 см. LDOS
- LEAPS (low-energy electron APS)
 спектроскопия потенциалов появления медленных /вторичных/ электронов
- LEC (liquid encapsulation Czochralski)
 метод Чохральского с жидкостной герметизацией
- LEEOA (LEED optical analyzer)
 оптический анализатор электронографа
- LEEIXS (low-energy electron induced X-ray spectroscopy)
 спектроскопия рентгеновского излучения, индуцированного бомбардировкой медленными электронами
- LEELS (low-energy electron loss spectroscopy)
 спектроскопия потерь энергии медленных электронов
 см. также LELS
- LEER (low-energy electron reflection)
 /спектроскопия/ медленных отраженных электронов
- LEES (low-energy electron spectroscopy)
 электронная спектроскопия в области низких энергий электронов
- LEF (light-emitting film)
 пленочный излучатель
- LEF-laser (lateral evanescent field laser)
 лазерный диод с продольным затухающим полем /с поперечным ограничением/
- LEGO (lateral epitaxial growth over oxide)
 эпитаксиальное разрастание над окислом
- LEIT (light emission via inelastic tunneling)
 оптическое излучение, возбужденное неупругим туннелированием /в МДП структурах/
- LEK (liquid encapsulation Kyropoulos)
 метод Киропулоса с жидкостной герметизацией
- LELS (low electron loss spectroscopy)
 см. LEELS
- LEMS (low-energy molecular-beam sputtering)
 распыление пучком медленных молекул
- LENS (low-energy neutral scattering)
 /спектроскопия/ рассеяния медленных нейтральных атомов
- LEO (lateral epitaxial overgrowth)
 эпитаксиальное разрастание над слоем диэлектрика
- LEO (linear electro-optic)
 линейный электро-оптический

кий эффект /эффект По-
кельса/

LEPD (low-energy po-
sitron diffraction)
дифракция медленных позит-
ронов

LESEM (low-energy scann-
ing electron microscop)

растровый электронный мик-
роскоп в режиме низких
энергий /медленных элект-
ронов/

LESR (ligh-induced
ESR)
оптически-индуцированный
ЭПР

LESS (local epitaxial
seeding of silicon)
локальное эпитаксиальное
осаждение кремния

LETJ (light emitting
tunnel junction)
светоизлучающий туннельный
переход

LFO (low-frequency
oscillations)
низкочастотные колебания

L-G (liquid-gas)
система /фазовый переход/
жидкость-газ

LGR-laser (localized-
gain region laser)
лазерный диод с локализо-
ванной /ограниченной/ об-
ластью усиления

LN (low/high)
изотипный переход с низ-
кой/высокой степенью ле-
гирования

LIB (light-ion beam)
пучок легких ионов

LID (laser-induced
damage)
повреждения, индуцирован-
ные лазерным облучением

LID (laser-induced
desorption)
десорбция, индуцированная
лазерным облучением

LIGR (lateral insulated
gate rectifier)
тиристор с боковым изоли-
рованным затвором

LIMA (laser-induced
ion mass-analysis)
масс-анализ ионов, эмити-
рованных под действием
лазерного излучения

LIMP (laser-induced me-
dium perturbation)
возмущение среды, индуци-
рованное лазерным облуче-
нием

LINAC (linear accele-
rator)
линейный ускоритель

Lin CMOS (linear CMOS)
КМОП структура с линейно-
совмещенными кремниевыми
затворами

LL, L² (long life)•
долговечный /с большим
сроком службы/

LLL (low light level)
низкий уровень освещенно-
сти

LLT (lifted lead
transistor)
транзистор с приподнятыми
выводами

LM (light modulator)
оптический модулятор

LMI(S) (liquid-metal
ion source)
жидкометаллический источник ионов

LMR (low molecular-
weight resist)
органический резист из ма-
териала с низким молеку-
лярным весом

LMS (laser mass-
spectrometry)
лазерная масс-спектромет-
рия /ЛМС/

LN (low noise)
малозумящий

LN (liquid nitrogen)
жидкий азот

LN₂ (liquid nitrogen)
см. LN

LO (longitudinal
optical)
продольный оптический
/фонон/

LOC (large optical
cavity)
большой оптический резонатор

LO-DMOS (double-di-
ffused MOS structure,
using LOCOS technology)
МОП транзистор, получен-
ный методом двойной диффу-
зии с применением локаль-
ного окисления кремния

LOES (laser optical
emission spectroscopy)
лазерная эмиссионная
спектроскопия

LO/HI (low-sensitive
resist on high-sen-
sitive resist)
система двуслойного ре-
зиста - низкочувствитель-
ный на высокочувствитель-
ном

LO/HI/LO (low-high-
low)
система трехслойного ре-
зиста с низкой/высокой/
низкой чувствительностью

LOM (lift-off method)
метод взрывной литогра-
фии /отслаивания/
см. также LT (lift-off
technique)

LOPAC (low-power-dissi-
pation bipolar IC)
биполярная ИС с малой
мощностью рассеяния

LP (low pressure)
низкое давление

LPCC (leaded plastic
chip carrier)
пластмассовый кристалло-
носитель с выводами

LP-MOCVD (low-pressure
metalorganic chemical
vapour deposition)
химическое осаждение из
паровой фазы металлоор-
ганики при низком давле-
нии

LP MO VPE (low pressure
MO VPE)
парофазная эпитаксия в
парах металлоорганики
низкого давления

LPMS (laser-probe mass-spectrometry) масс-спектрометрия с лазерным зондом	LS (logic scheme) логическая схема
LPP (laser produced plasma) лазерная плазма	LSA (laser surface alloying) поверхностное лазерное легирование
LPPD (low pressure plasma deposition) плазменное осаждение при низком давлении	LSA (laser scanning array) матрица, сканируемая лазерным лучом
LPSEI (low pressure selective epitaxial isolation) изоляция методом селективной эпитаксии при низком давлении	LSA (light-switching array) светоклапанная панель
LPVE (lateral photovoltaic effect) продольный фотогальванический эффект	LSC (luminescent solar concentrator) люминесцентный концентратор солнечного излучения
LQ-a-Si (liquid-quenched a-Si) аморфный Si, полученный закалкой расплава	LSDI (large-scale display integration) технология индикаторов с высокой степенью интеграции
LR (laser recrystallization) лазерная рекристаллизация	LSIC (low-speed IC) ИС на частотный диапазон 0,1 МГц
LRF (laser resonance fluorescence) лазерная резонансная флуоресценция	LSI/DRA (LSI/discretionary routed array) ВИС с избирательными соединениями
LRO (long-range order) дальний порядок /атомная корреляция на больших расстояниях/	LSM (laser surface melting) поверхностное плавление с помощью лазерного облучения
LRS (laser Raman spectroscopy) лазерная спектроскопия комбинационного рассеяния	LSPE (lateral solid phase epitaxy) боковая твердофазная эпитаксия /разрачивание в стороны/

LSR (lift-off using selective reaction)
снятие слоя методом селективных реакций

LSR (load shifting register)
сдвиговый регистр загрузки

LSR (large storage ring)
большое накопительное кольцо

LSSL (lateral surface superlattice)
продольная поверхностная сверхрешетка

LT (lateral transistor)
горизонтальный /продольный/ транзистор

LT (lift-off technique)
см. LOM

LTA (low-temperature annealing)
низкотемпературный отжиг

LT CVD (low temperature CVD)
низкотемпературное химическое осаждение из паровой фазы

LTE (local thermodynamic equilibrium)
локальное термодинамическое равновесие

LTQSIT(hy) (light triggered and light quenched static induction thyristor)
оптически отпираемый и оптически запираемый тири-

стор со статической индукцией

LTT (light triggered thyristor)
фототиристор

LVA (low-voltage avalanche)
лавинный пробой при низком напряжении

LVE (vapour levitation epitaxy)
парофазная левитационная эпитаксия /подложка "плавает", поддерживаемая давлением газа-носителя, что обеспечивает высокую равномерность осаждения/

LVM (localized vibrational mode)
локализованная колебательная мода /в спектро-скопии ИК излучения/

LVSEM (low voltage scanning electron microscope)
низковольтный растровый электронный микроскоп

LVT(S) (low-voltage triode sputtering)
низковольтная триодная распылительная система

LWD (laser welder/driller)
лазерная сварка/сверление

LWIR (long-wave infrared) imagery
приборы видения в длинноволновой ИК области спектра /8-12 мкм/

LWL (linewidth control)

фиксация размера /обеспечение точного воспроизведения ширины линий в технологии ИС/

LW-PD (long wavelength photodiode)

фотодиод, чувствительный в длинноволновой ИК области спектра

LWT (lightwave technology)

технология оптической обработки

М

MAGFET (modulation-doped arsenide-gallium FET)

модуляционно-легированный GaAs ПТ /со слоем AlGaAs между GaAs и n-GaAs)

MAMA (multi-anode microchannel array)

многоанодная микроканальная матрица

MANOS (metal-alumina-nitride-oxide-semiconductor)

структура металл - окись алюминия - нитрид кремния - двуокись кремния - полупроводник /МАНОП/

MASFET (metal-alumina-semiconductor FET)

ПТ с МАП структурой

MBC (miniature beryllia circuit)

СВЧ-ИС на основе BeO-керамики

MBI (multiple-beam interferometry)

многолучевая интерферометрия

MBM (metal-barrier-metal)

структура металл-барьерный слой-металл /МБМ/

MBMS (modulated-beam mass-spectrometer)

масс-спектрометр с модуляцией пучка

MBP (modulated barrier photodiode)

фотодиод с модулированным /по высоте/ барьером

MC (metal-capillary)

металлопористый /катод/

MC (metallized ceramics)

металлизируемая керамика

MC (multilayer ceramics)

многослойная керамика /керамический модуль/

M-C (Monte-Carlo method)

расчет методом Монте-Карло

MCB (merged CMOS/bipolar)

технология совмещенных структур КМОП/биполярный транзистор

MCDL (minority carrier diffusion length)
диффузионная длина неосновных носителей

MCF (microcleaved facets)
микросколотые грани

MCM (multi-chip module)
многокристальный модуль

MCP (microchannel plate)
микрочанальная пластина /МКП/

MCPM (microchannel photomultiplier)
микрочанальный фотоумножитель /ФЭУ с МКП/

MCRW (metal-clad ridge-waveguide)
металлизированный реберный волновод

MCRW-laser (multicavity ridged waveguide laser)
многорезонаторный лазерный диод с реберным волноводом

MCSP (modified channel-ed-substrate planar)
модифицированный планарный /лазерный диод/ с каналом в подложке

MCT (mercury-cadmium telluride)
теллурид кадмия-ртути см. также СНТ

MCT (MOS-controlled thyristor)
мощный тиристор, управляемый с помощью МОП ИС

MCVD (modified chemical vapor deposition)
модифицированное химическое осаждение /кварца/ из паровой фазы

MD (misfit dislocation)

дислокация несоответствия /решеток/

MD (modulation-doped heterostructure)
модуляционно-легированная гетероструктура

MDA (magnetic deflection analyzer)
энергоанализатор с магнитным отклонением

MDM (metal-dielectric-metal)
структура металл-диэлектрик-металл /МДМ/

ME (magnetoelectret)
магнетоэлектрет

ME (meander electrode)
меандровый электрод

MEBES (manufacturing electron-beam exposure system)
технологическая установка для электронно-лучевой обработки

MEED (medium energy electron diffraction)
дифракция электронов средних энергий

MEG (multipactor
electron gun)
мультипакторная электрон-
ная пушка

MEIS (medium-energy
ion scattering)
/спектроскопия/ рассеяния
ионов средних энергий

MEIS LD (melt-etched
inner stripe laser diode)
лазерный диод с вытравлен-
ной проплавкой внутренней
полосковой структурой

MEM (mirror electron
microscope)
зеркальный электронный
микроскоп
см. также EMM

MEMISTOR (memory
resistor)
запоминающий резистор

MEPC (multielement
proportional counter)
многоэлементный пропорцио-
нальный счетчик

MESD (muptidelectrode
silicon detector)
многоэлектродная матрица
кремниевых детекторов
радиации

MFP (mean free path)
средняя длина пробега

MFS FET (metal-ferroelectric-
semiconductor FET)
ПТ со структурой затвора
металл-сегнетоэлектрик-
полупроводник

MGS (multilayer glass-
ceramic)
многослойная стеклокера-
мическая /подложка/

MGOS (metal-graded
oxide-semiconductor)
МОП структура с постепен-
но наращиваемым /различны-
ми методами/ слоем окисла

MGS (monolithic
GaAs/Si)
монокристаллическая интеграция
GaAs/Si структур

MHS-PD (minority-hole
sunked photodetector)
/быстродействующий/ фото-
резистор с дополнительным
затвором для вывода /мед-
ленных/ дырок /неоснов-
ных носителей/

MI (monolithic integ-
ration)
монокристаллическая интеграция

MIBE (molecular and ion
beam epitaxy)
молекулярно-ионно-лучевая
эпитаксия

MIBL (masked ion-beam
lithography)
ионно-лучевая литография
с использованием масок

MID (magnetically-insu-
lated diode)
диод с магнитной изоляци-
ей

MII (maskless ion
implantation)
безмасочное ионное леги-
рование

MINP (metal-insulator-
np-junction)
структура металл-диэлект-
рик-п-р переход

MIR (mid-infrared)
излучение среднего ИК диа-
пазона /3-5 мкм/
см. также MWIR

MIS (metal ion source)
металлический ионный ис-
точник

MISIM (metal-insulator-
semiconductor-insulator-
metal)
МДПДМ структура

MISM (metal-insulator-
semiconductor-metal)
структура металл-диэлект-
рик-полупроводник-металл
/МДПМ/

MISS (metal-thin insu-
lator-nSI-p+Si)
структура металл-тонкий
слой диэлектрика -np+ по-
лупроводниковый переход

MISS-FET (metal-thin
insulator-np + semicon-
ductor FET)
полевой транзистор со
структурой металл-тонкий
слой диэлектрика-полупро-
водниковый np+ переход

MIST (MIS thyristor)
МДП тиристор

MITATT (mixed tunneling-
avalanche transit-
time)
пролетный диод со смешан-
ной туннельной и лавинной
инжекцией

ML (monolayer)
монослой /моноатомный, мо-
номолекулярный/

MLEC (magnetic-field-
applied LEC)
метод Чохральского с жид-
костной герметизацией с
приложением магнитного
поля

MLI (multilayer in-
sulation)
многослойная изоляция

MMM (mixed-metal-
matrix)
металлопористый /катод/
на основе матрицы из сме-
си металлов

MNOSFET (metal-nitride-
oxide-semiconductor
FET)
полевой транзистор с МНОП
структурой

МО (metallo-organics)
металлоорганические со-
единения /МОС/
см. также ОМ

МО (molecular
orbital)
молекулярная орбиталь

МО (monochip)
гибридная ИС /ГИС/, со-
стоящая из отдельных
кристаллов

MOD (magneto-optic
device)
магнито-оптический прибор

MODFET (modulation-
doped FET)
модуляционно-легированный
ПТ

МОКЕ (magneto optic Kerr
effect)
магнито-оптический эффект
Керра

- MO-MBE (combines MOCVD and MBE)
комбинация молекулярно-лучевой эпитаксии и химического осаждения из паровой фазы металлоорганических соединений
см. также CBE
- MONOS (metal-oxide-nitride-oxide-semiconductor)
МОНОП структура
- MOPS (metal-oxide-passivated silicon)
кремний, пассивированный окислом металла
- MOSFIC (MOS film IC)
пленочная МОП ИС
- MO-VPE (metal-organic vapour-phase epitaxy)
парофазная эпитаксия из металлоорганических соединений
см. также OM-VPE
- MPA (multi-photon absorption)
многофотонное поглощение
- MPE (microwave plasma etching)
травление в СВЧ плазме
- MPE (multiphonon emission)
многофононная эмиссия
- MPL (molecular-pattern lithography)
молекулярная литография
- MPOS (metal-phosphor-silicate glass-oxide-semiconductor)
структура металл-фосфорно-силикатное стекло-окисел-полупроводник
- MPPE (multi-photon photoemission)
многофотонная фотоэмиссия
- MPX (multiplexing)
мультиплексирование
см. MUX
- MQAS (mean quadratic angular spread)
среднее квадратичное значение углового расхождения /электронного луча/
- MQW (multiple quantum-well)
многослойная структура с квантово-размерным эффектом /периодическая структура квантовых ям/
- MQWH (multiple quantum-well heterostructure)
многослойная гетероструктура с квантовыми ямами /с квантово-размерным эффектом/
- MRIS (multiple-reflection IR-spectroscopy)
ИК спектроскопия многократного отражения

MRT (minimum resolvable temperature)	MSMR (mixed suspension, mixed product removal)
минимальная разрешающая разность температур /тепловизора/	непрерывный кристаллизатор с удалением смешанного продукта
MS (mass-spectrometry) масс-спектрометрия	MSSW (magnetostatic surface wave)
MS (mushroom stripe) полосковая структура грибовидного профиля	магнитостатическая поверхностная волна
MSA (multiwall self-alignment) многостеночное самосовмещение	MST (monolithic system technology) технология монолитных ИС
MSBVW (magnetostatic-backward volume wave) обратная объемная магнитостатическая волна	MSW (magnetostatic wave) магнитостатическая волна
MSC (multistep avalanche chamber) многоступенчатая лавинная ионизационная камера	MTBF (mean time between failures) средняя наработка на отказ /среднее время между отказами/ см. также MTTF
MSE (minimum-size effects) эффекты, связанные с предельным уменьшением размеров	MTDH (multiple twisted double heterostructure) многократно закрученная двойная гетероструктура
MSGCC (monolithic shallow-groove coupled-cavity) laser монолитная лазерная структура с приповерхностными связанными резонаторами	MTF (modulation transfer function) частотно-контрастная характеристика /ЧКХ/ см. также CMF
MSLM (microchannel spatial light modulator) микроканальный пространственный модулятор света	MTG (milky tin-oxide on glass) белая окись олова на стекле
	MTOS (metal-tantalum oxide-silicon dioxide-silicon)

структура металл-окись
тантала-двуокись крем-
ния-кремний

MTS (multitarget
sputtering)

катодное распыление с ис-
пользованием нескольких
мишеней

MTTF (mean time to
failure)

см. MTBF

MUSA/MOST (multiple
self-alignment MOS
technology)

МОП технология с много-
кратным самосовмещением

MUX (multiplexing)

мультиплексирование
см. также МРХ

MVL (metal vapour
laser)

лазер на парах металла

MVM (metal-vacuum-
metal)

переход металл-вакуум-
металл

MWIR (mid-wavelength
IR)

см. MIR

MW-PD (mid-wavelength
photodiode)

фотодиод, чувстви-
тельный в средней ИК области
спектра

N

NAA (neutron activa-
tion analysis)

нейтронный-активационный
анализ

NAC (nematic-A-C-
smectic)

точка перехода нематичес-
кой фазы в смектическую
А- и С-фазу /жидкокристал-
лической смеси/

NAM (nonabsorbing
mirror)

непоглощающее зеркало

NAMIS (nitrid-barrier
avalanche injection
MIS)

МДП структура с лавинной
инжекцией с барьером из
нитрида кремния

NASICON (Na-superionic
conductor)

($\text{Na}_3\text{Zr}_2\text{PSi}_2\text{O}_{12}$)

сверхионный проводник с
подвижными ионами натрия

NBE (near-band-edge)

краевое /излучение/

NDC (nondestructive
control)

неразрушающий контроль
см. также NDT

NDR (negative differen-
tial resistance)

отрицательное дифферен-
циальное сопротивление

NDT (nondestructive
testing)

см. NDC

NEA (negative electron
affinity)

отрицательное электрон-
ное сродство /ОЭС/

NEMAG (negative effec-
tive mass amplifier
and generator)

полупроводниковый лазер

на циклотронном резонансе тяжелых дырок с отрицательной эффективной массой

NEQ (noise equivalent number of quanta)

эквивалентное шуму число фотонов

NE Δ T (noise equivalent temperature difference)

см. NETD

NETD (noise equivalent temperature difference)

эквивалентная шуму разность температур /тепловых приемников/
см. также NE Δ T

NEXAFS (near-edge X-ray absorption fine structure)

тонкая структура спектров краевого рентгеновского поглощения

NGS (narrow-gap semiconductor)

узкозонный /узкощелевой/ полупроводник

NID (nonintentionally doped)

непреднамеренно-легированный

NIM (normal-incidence monochromator)

монокроматор с падением излучения по нормали

NIR (near IR)

ближнее ИК излучение

NO (nitridized oxide)

нитрированный с поверхности окисел

NON (surface-interface nitridized oxide)

окисел, нитрированный с поверхности и по границе с подложкой /нитрид-окисел-нитрид/

NORA (nonoverlapping redundant array)

/фотоприемная/ матрица с избыточным количеством неперекрывающихся элементов

NR (negative resist)

негативный резист

NSA (nitride self-alignment)

технология самосовмещения с изоляцией нитридом кремния

NSL (normal superlattice)

нормальная сверхрешетка /CP/ /подложка /n⁺/n⁻/CH/n⁺)

NTD (neutron transmutation doping)

легирование методом нейтронной трансмутации

NUDJFET (nonuniformly doped junction FET)

ПТ с неоднородно-легированным управляющим переходом

NUV (near ultraviolet)

ближнее УФ излучение

NWE (narrow width effect)

эффект близости

n-well CMOS

КМОП структура с n-карманом

О

- OA (optoacoustics)
оптоакустика
- OB (optical bistability)
оптическая бистабильность
- OCTIGUN (octupole ion gun)
ионная пушка с октупольной фокусирующей системой
- OC translaser (optically coupled transistor laser)
оптически связанные полевой транзистор и лазер на общей подложке /бистабильный переключатель/
- OCV (open-circuit voltage)
напряжение холостого хода
- OD (order-disorder)
/фазовый переход/ порядок-беспорядок
- ODE (orientation-dependent etching)
ориентационное травление
- ODMR (optically-detected magnetic resonance)
оптически детектируемый магнитный резонанс /ОДМР/
- OED (oxidation enhanced diffusion)
ускоренная окислением диффузия
- OEMI (open end Michelson interferometric)
резонатор в виде открытого интерферометра Майкельсона
- OES (optical emission spectroscopy)
оптическая эмиссионная спектроскопия
- OF (optical fiber)
оптическое волокно
- OFCL (optical fibre communication line)
волоконно-оптическая линия связи
- OG (optical guide)
световод
- OGE (optogalvanic effect)
оптогальванический эффект /изменение напряжения горения тлеющего разряда под действием лазерного облучения плазмы/
- OGST (opposed gate-source transistor)
полевой транзистор с вертикальной геометрией, с истоком и затвором Шоттки на противоположных поверхностях
- OISF (oxidation-induced stacking-faults)
дефекты упаковки, индуцированные окислением см. также OSF
- OK (optical klystron)
оптический клистрон /лазер на свободных электронах/
см. также FEL
- OLD (optoacoustic laser-beam deflection)
оптоакустическое отклонение лазерного луча

OM (organometallic)
металлоорганическое соедине-
ние /МОС/
см. также MO

OM (optical micro-
scopy)
оптическая микроскопия

OM CVD (organometallic
CVD)
химическое осаждение из
паровой фазы металлоорга-
нических соединений

OMO (oxidized metal
overlay)
покрытие из окисла металла

OM VPE (organometallic
VPE)
парофазная эпитаксия из
металлоорганических сое-
динений
см. также MOVPE

ONO (oxide-nitride-
oxide)
трехслойный подзатворный
диэлектрик окисел-нитрид-
окисел

OPFET (optical FET)
полевой фототранзистор

OPO (optical paramet-
ric oscillator)
параметрический генера-
тор оптического излучения

OPOS (oxygen-doped
polysilicon)
легированный кислородом
поликремний

OPS (oxidized porous
silicon)
окисленный пористый крем-
ний

ORD (oxidation retard-
ed diffusion)
замедленная окислением
диффузия

OSF (oxidation-induced
stacking faults)
см. OISF

OSL (optically-stimu-
lated luminescence)
фотостимулированная лю-
минесценция

OSP (opto-electronic
signal processor)
оптоэлектронный преобра-
зователь сигнала

OTCS (optical-induced
transient-current
spectroscopy)
релаксационная спектро-
скопия фотоиндуцированно-
го тока
см. также PICTS

OVD (outside vapour
deposition)
наружное парофазное осаж-
дение /в технологии оп-
тического волокна/

Р

PA (photoinduced
absorption)
фотоиндуцированное опти-
ческое поглощение

PACE (producible alter-
native to CdTe for
epitaxy)
подложка, заменяющая объ-
емный CdTe для эпитаксии
HgCdTe /сапфир с эпитак-
сиальным слоем CdTe /

PACVD (plasma-assisted CVD)	ванного ксенона /метод определения поверхностной топологии работы выхода неоднородных поверхностей/
см. PCVD	
PADESР (photoinduced absorption-detected electron spin resonance)	PВ (photon beam) поток фотонов
ЭПР, регистрируемый по фотоиндуцированному поглощению	PBC (periodic bond chain) периодическая цепь связей /в кристалле/
PAE (photoacoustic effect)	PBC-laser (p-substrate buried crescent laser)
фотоакустический эффект	
PAM (photoacoustic microscopy)	лазерный диод со скрытой серповидной InGaAsP активной областью на pInP подложке
фотоакустическая микроскопия	
PAPVD (plasma-assisted physical vapor deposition)	PВН (planar buried heterostructure) планарная скрытая гетероструктура
физическое осаждение из паровой фазы в плазме	
PARPES (polarization-dependent angle-resolved photoemission spectroscopy)	PBN (pyrolytic boron nitride) пиролитический нитрид бора
поляризационно-чувствительная фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением	
PARUPS (polarization-dependent angle resolved ultraviolet photoemission spectroscopy)	PC (photocathode) фотокатод
поляризационно-чувствительная УФ фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением	
PAX (photoemission of adsorbed xenon)	PC (photoconductive) фотопроводящий
фотоэмиссия с адсорбированного ксенона /метод определения поверхностной топологии работы выхода неоднородных поверхностей/	
	PCD (photoconductive detector) фоторезистор
	PCD (photoconductivity decay) метод определения времени жизни носителей заряда по спаду фотопроводимости
	PCD (photon counting detector) счетчик фотонов

PCD (plasma-coupled device)	PD (photodetector)
прибор с плазменной связью /сдвиговой регистр с близко расположенными элементами с отрицательным сопротивлением/	фотоприемник
p-ch MOSFET (pinch-through MOSFET)	PD (photodiode)
МОП ПТ со смыканием областей пространственного заряда /с проколом/	фотодиод
PCM (portable conformal mask)	PDA (photodiode array)
съемный конформный /гибкий/ шаблон	фотодиодная матрица
PCM (photochemical machining)	PDB(T) (planar depletion-base) transistor
фотохимическая обработка	планарный транзистор с обедненной базой
PCM (phase-conjugate mirror)	PDB(T) (planar-doped barrier) transistor
фазово-сопряженный отражатель	транзистор с планарным легированным барьером /треугольной формы/
PCPS (photoconductive power switch)	PDC CAD (process-device-circuit computer-aided design)
мощный переключатель на фоторезисторах	машинное проектирование полного цикла технология-прибор-схема
PCR (phase-conjugate resonator)	PDP (plasma-developable photoresist)
фазово-сопряженный резонатор	фоторезист с плазменным проявлением
PCS (photoconductive spectroscopy)	PDP (plasma deposition process)
спектроскопия фотопроводимости	процесс плазменного осаждения
PCVD (plasma chemical vapour deposition)	PDT (photo-Darlington transistor)
плазмохимическое осаждение из паровой фазы см. также PACVD	фототранзистор в схеме Дарлингтона /фотодарлингтон/
	PDT (proportional drift tube)
	пропорциональная дрейфовая камера

PE (plasma etching)
плазменное травление

PE (polyethylene)
полиэтилен

PEA (positive electron
affinity)
положительное электронное
средство

PEC (photoelectroche-
mical cell)
фотоэлектрохимическая
ячейка

PEC (photoelectroche-
mical etching)
фотоэлектрохимическое
травление

PED (plastic encapsu-
lated device)
прибор в пластмассовом
корпусе

PED (proton-excited
diffusion)
диффузия под действием
протонного облучения

PED (parabolic energy
distribution)
энергетическое распределе-
ние по параболическому
закону

PEEE (photo-exoelectron
emission)
см. PSEE

PEEM (photoemission
electron microscope)
фотоэмиссионный электрон-
ный микроскоп

PEFS (photoemission
extended fine structure)
тонкая структура запоро-

гового спектра фото-
эмиссии

PEL (powder electro-
luminescent)
электролюминесцентный из-
лучатель с порошковым лю-
минофором

PEM (photoelectron
multiplier)
фотоэлектронный умножитель
/ФЭУ/

PEM (photoelectro-
magnetic)
фотомагнитоэлектрический
эффект /ФМЭ/

PEME (photo-electro-
motive force)
фото-э.д.с.

PE-MOCVD (plasma-
enhanced MOCVD)
плазмо-химическое осажде-
ние из паровой фазы ме-
таллоорганических соеди-
нений

PEOS (plasma erosion
opening switch)
плазменный эрозионный
размыкатель

PES (photoemission
spectroscopy)
фотоэлектронная спектро-
скопия

PESC (passivated-
emitter solar cell)
солнечный элемент с пас-
сивированной поверхностью
эмиттера

PESC (photoelectro-
chemical solar cell)
фотоэлектрохимический
солнечный элемент

- PESIS (photoelectron spectroscopy of inner shell)
 фотоэлектронная спектроскопия внутренних оболочек /атомов/
- PESH (photoelectron spectro-microscopy)
 фотоэлектронная спектроскопия
- PEV (pyroelectric vidicon)
 пироэлектрический видикон /пировидикон/
- PEYS (photoelectron yield spectroscopy)
 спектроскопия квантового выхода фотоэмиссии
- P-F (Poole-Frenkel) /эффект/ Пула-Френкеля
- PFES (photo-field emission spectroscopy)
 автофотоэмиссионная спектроскопия
- PFET (power FET)
 мощный полевой транзистор
- PG (pyrolytic graphite)
 пиролитический графит
- PGA (pyroelectric gas analyzer)
 пироэлектрический газоанализатор
- PGE (photogalvanic effect)
 фотогальванический эффект
- PGM (plane grating monochromator)
 монохроматор с плоской дифракционной решеткой
- PHD (pulse-height distribution)
 амплитудное распределение
- photo-CVD (photochemical vapour deposition)
 фотохимическое осаждение из паровой фазы
- photo-VPE
 фотохимически активируемая парофазная эпитаксия
- PhPE (photoplastic effect)
 см. PPE
- PIC (power IC)
 мощная ИС
- PIC-LED (picture LED)
 светодиодная панель
- PICTS (photoinduced current transient spectroscopy)
 релаксационная спектроскопия фотоиндуцированного тока
 см. также OTCS
- PICVD (plasma-induced CVD)
 плазмохимическое осаждение из паровой фазы
- PID (pulse implantation doping)
 импульсное ионное легирование
- PIE (plasma-induced emission/spectroscopy)
 спектроскопия индуцированного плазмой излучения
- PIES (Penning ionization electron spectroscopy)

PIFET (piezoelectric-film FET)
полевой транзистор на пьезоэлектрической пленке

PIGatron (Penning-ionization gauge)
ионизационный манометр типа Пеннинга /магнитно-разрядный манометр/

PIGE (particle-induced gamma-ray emission)
тормозное гамма-излучение

PI-MBE (partially-ionized molecular-beam epitaxy)
молекулярно-лучевая эпитаксия с частичной ионизацией пучка

PINFET (pin-gate FET)
полевой транзистор с pin-затвором

PINFET (pin-diode - FET)
модуль, состоящий из pin-диода и полевого транзистора

PIN-FET (monolithically integrated pin-PD - FET-preamplifier)
фотоприемник в виде монолитно интегрированных pin фотодиода и предусилителя на ПТ

PIRLS (photo-induced Ralaigh light scattering)
фотостимулированное рэлеевское рассеяние излучения

PIXE (particle-induced X-ray emission)
рентгеновское излучение, индуцированное заряженными частицами /протонами/

PJGFET (p-channel junction-gate FET)
р-канальный ПТ с управляющим рп переходом

PL (photolithography)
фотолитография

PL (photoluminescence)
фотолюминесценция

PL (pulsed laser)
импульсный лазер

PLASA (planar-mesa)
меза-планарная /технология/

PLATMOS (platinum-diffused MOS)
МОП структура, полученная с помощью диффузии платины

PLCC (plastic leadless chip carrier)
безвыводный пластиковый корпус

PLEED (polarized low-energy electron diffraction)
дифракция медленных поляризованных электронов

PLID (pulsed-laser-induced desorption)
десорбция, индуцированная импульсным лазерным облучением

PLOSS (photoconductive layer on solid scanner) преобразующий фотопроводящий слой на твердотельном сканирующем устройстве

PLPDL (pulsed laser pumped dye laser) лазер на красителях с импульсной лазерной накачкой

PLZT (PbLaZrTi) цирконат-титанат лантана-свинца /ЦТЛС/ /пьезо керамика/

PMD (planar magnetic domain) плоский магнитный домен /ПМД/

PMGT (p-channel metal-gate transistor) р-канальный ПТ с металлическим затвором

PMJ (planar multijunction) планарный каскадный /солнечный элемент/

PMLC (pressed multilayer cathode) прессованный многослойный матричный катод

PMMA (polymethylmethacrylate) долиметилметакрилат /фоторезист/

PMP (planar metallization with polymer) планарная металлизация с последующим нанесением пленки полимера

PMRAS (polarization modulation reflection-absorption spectroscopy) спектроскопия отражения и поглощения излучения с модуляцией поляризации

PN (phosphorus nitride) нитрид фосфора

POSFET (piezoelectric-oxide-semiconductor FET) ПТ со структурой пьезоэлектрик-окисел-полупроводник

PP (plasma polymerization) плазменная полимеризация

PPAC (parallel-plate avalanche counter) газоразрядный лавинный счетчик с параллельными пластинами

PPC (persistent photoconductivity) остаточная фотопроводимость

PPE (persistent photoconductivity effect) эффект остаточной фотопроводимости

PPE (photoplastic effect) фотомеханический /фотопластический/ эффект см. также рРЕ

PPEM (parallel-plate electron multiplier)

электронный умножитель с параллельными пластинами /щелевого типа/

P^2ES (photopyroelectric spectroscopy)
фотопироэлектрическая спектроскопия /исследование фазовых переходов/

PPM (periodic permanent magnet)
постоянный магнит с периодической структурой /фокусирующая система для ЛБВ/

PPTFE (plasma-polymerized polytetrafluoroethylene)
политетрафторэтилен, полученный плазменной полимеризацией

PR (photoresist)
фоторезист

PR (positive resist)
позитивный резист

PRA (prompt radiation analysis)
быстрый радиационный анализ /нейтронный активационный анализ/

PRD (proton recoil detection)
метод регистрации протонов отдачи /метод анализа материалов/

PRD (pinch-reflex diode)
пинчевый отражательный диод

PRE (pyroelectric)
пироэлектрик

PS (porous silicon)
пористый кремний

PS (planar stripe)
планарная полосковая структура

PSA (polysilicon self-alignment)
технология БИС на основе поликремния с самосовмещением

PSA (pattern shape adjustment)
технология с точным совмещением выводов эмиттера и базы /с использованием поликремния/

PSC (planar spark counter)
плоский искровой счетчик

PSD (photon-stimulated desorption)
фотостимулированная десорбция

PSD (polysilicon diode)
диод из поликристаллического кремния

PSEE (photo-stimulated exoelectron emission)
фотостимулированная экзoeлектронная эмиссия см. также PEEE

PSES (polarized secondary-electron spectroscopy)
спектроскопия поляризованных вторичных электронов

- PSID (planar-type self-magnetically insulated diode)
планарный диод с собственной магнитной изоляцией
- PTB (pyroelectric-thermistor bolometer)
пирозлектрический термисторный болометр
- PTIS (photothermal ionization spectroscopy)
фототермическая ионизационная спектроскопия
- PTL (photostimulated thermoluminescence)
фотостимулированная термолюминесценция /ФТЛ/
- PUCOT (piezoelectric ultrasonic composite oscillator technique)
метод составного пьезоэлектрического ультразвукового вибратора
- PV (photovoltaic)
фотогальванический
- PVAC (photovoltaically active)
фотогальванически-активный /полупроводник/
- PVD (physical vapour deposition)
физическое осаждение из паровой фазы
- PVD (plasma vapour deposition)
плазменное парофазное осаждение
- p-well CMOS
КМОП структура с р-карманом
- PWI (plasma-wall interactions)
взаимодействия плазмы со стенкой
- PYS (photoemission yield spectroscopy)
спектроскопия квантового выхода фотоэмиссии
- PZE (piezoelectric)
пьезоэлектрик
- PZT (PbZrTi)
цирконат-титанат свинца /пьезокерамика/
- ## Q
- QC (quantum counter)
счетчик фотонов
- QCM (quartz crystal microbalance)
микровесы на кварцевом вибраторе
- Q1D (quasi-one-dimensional)
квази-одномерный /электронный газ/
- Q2D (quasi-two-dimensional)
квази-двумерный /электронный газ/
- QED (quantum electrodynamics)
квантовая электродинамика
- QEL (quasi-Fermi level)
квазиуровень Ферми
- Q-MAS (quadrupole mass-analysis spectrometer)
см. QMS

QМOS (quick MOS)
быстродействующая МОП ИС

QMPA (quantitative microprobe analysis)
количественный микрозондовый анализ

QMS (quadrupole mass-spectroscop)
квадрупольный масс-спектрометр
см. также Q-MAS

QSA (quadruple self alignment)
четырежды самосовмещение /в МОП технологии/

QSE (quantum size effect)
эффект размерного квантования /квантово-размерный эффект/

QUILP (quadruple-inline package)
корпус ИС с четырехрядным расположением выводов

QW (quantum well)
квантовая яма /размерное квантование/

QWH (quantum-well heterostructure)
гетероструктура с эффектом размерного квантования

QWS (quantum-well structure)
структура с квантово-размерным эффектом /с квантовыми ямами, СКЯ/

QWSCH (quantum-well separate confinement heterostructure)

гетеролазер с отдельным ограничением на структуру с квантово-размерным эффектом

R

RA (resistance-area)
произведение сопротивления/при нулевом смещении/ на площадь приемной поверхности фотоприемника

RAIR(S) (reflection absorption IR) spectroscopy)
см. RAIS

RAIS (reflection-absorption IR spectroscopy)
отражательно-абсорбционная спектроскопия ИК излучения
см. также RAIR(S)

RBDT (reverse-biased diode-thyristor)
диодный тиристор, запираемый по аноду

RBS (Rutherford back-scattering spectroscopy)
спектроскопия обратного резерфордского рассеяния быстрых ионов
см. также BRS

RCE (resonant coherent excitation)
резонансное когерентное возбуждение

RCT (reverse conducting thyristor)
тиристор с антипараллельными диодами

RDE (reactive deposition epitaxy) реактивное эпитаксиальное выращивание пленок /напр., силицидов/	глубленным /скрытым/ затвором
RE (rare earth) редкоземельный элемент	RGSIT (recessed-gate SIT) транзистор со статической индукцией с заглубленным /скрытым/ затвором
REB (relativistic electron beam) релятивистский электрон- ный пучок /РЭП/	RHEED (row-angle HEED) дифракция быстрых элект- ронов, падающих под сколь- зящим углом
RED (reflection electron diffraction) дифракция отраженных эле- ктронов	RIA (rapid isothermal annealing) быстрый изотермический отжиг
REG (relativistic electron gun) релятивистская электрон- ная пушка	RIC (radiation-induc- ed conductivity) проводимость, индуцирован- ная облучением
REM (reflection electron microscope) отражательный электронный микроскоп	R-ICB (reactive ioniz- ed cluster beam (de- position) реактивное осаждение плен- нок методом ионизирован- ных кластеров
REM (reflection mode) отражательный режим	RIE (reactive-ion etching) реактивное ионное травле- ние
RFA (retarding field analyzer) энергоанализатор типа за- держивающего потенциала	RIG (rare-earth iron garnet) редкоземельно-железный гранат
RFSEM (retarding field scanning electron microscope) растровый электронный мик- роскоп /РЭМ/ в режиме за- держивающего потенциала	RIGD (refractive in- dex to gain deriva- tive) производная показателя преломления по усилению /в оптических волноводах/
RG (residual gas) остаточный газ /в ЭВП/	
RGFET (recessed-gate FET) полевой транзистор с за-	

- RIMS (resonance ionization mass-spectrometry)
резонансная ионизационная масс-спектрометрия /с лазерным возбуждением/
- RIN (relative intensity noise)
относительная величина шума
- RINS (rotating target neutron source)
источник нейтронов с вращающейся мишенью
- RIP (reactive ion plating)
нанесение покрытий методом реактивного ионного распыления
- RIS (radiation-induced segregation)
сегрегация, индуцированная облучением
- RIS (resistor-insulator-semiconductor)
структура резистивный слой-диэлектрик-полупроводник /РДП/
- RIS (resonance ionization spectroscopy)
резонансная ионизационная спектроскопия
- RLS (resonant light scattering)
резонансное рассеяние света
- RMBE (reactive MBE)
реактивная молекулярно-лучевая эпитаксия
- RMIS (refractory metal-insulator-semiconductor)
МДП-структура с тугоплавким металлом
- RM-MOSFET (relaxation-mode MOSFET)
МОП ПТ в режиме релаксации
- RMPI (resonant multi-photon ionization)
резонансная многофотонная ионизация
- ROGI (refilled oxide groove isolation)
изоляция повторным заполнением канавки окислом
- ROS (resistor on sapphire)
резистивный слой на сапфире
- RP (reverse photolithography)
обратная фотолитография
- RPA (retarding potential analyzer)
энергоанализатор типа задерживающего потенциала
- RPC (reduced pressure collapsing)
метод изготовления оптического волокна при пониженном давлении сжатия
- RPE (relativistic photoelectrons)
релятивистские фотоэлектроны
- RPP (reactive pulse plasma)
реактивная импульсная плазма

RS (Raman scattering)
комбинационное рассеяние
света /КРС/

RS (recoil spectro-
scopy)
спектроскопия атомов от-
дачи

RSAM (reflecting scann-
ing acoustic microscop)
растровый акустический
микроскоп в режиме отра-
жения

RSE (reactive sputter
etching)
травление реактивным рас-
пылением

RSR (relative spectral
response)
относительная спектраль-
ная чувствительность

RSR (resonance Raman
scattering)
резонансное комбинацион-
ное рассеяние

RTA (rapid thermal
annealing)
быстрый термический отжиг
см. также RTP

RTI (real-time indi-
cator)
индикатор в реальном
масштабе времени

RTN (rapid thermal
nitridization)
быстрое термическое нитри-
рование

RTP (rapid thermal
processing)
см. RTA

RVLSI (restructurable
VLSI)
СВИС с возможностью пере-
стройки функций

RWG (ridge-waveguide)
реберный волновод

XRXT (reflection X-ray
topography)
отражательная рентгеновс-
кая топография

S

SAC (self-aligned-
contact)
самосовмещенный контакт

SACSFET (sidewall-
assisted closely-spac-
ed electrode FET)
ПТ с близко расположенны-
ми электродами с использо-
ванием боковых стенок

SAD (selected area
diffraction)
микродифракция, дифракция
электронов от выбранной
области на изображении
/в просвечивающем элект-
ронном микроскопе/

SAD (small-angle
diffraction)
малоугловая дифракция

SADL (self-aligned
cell by DL-technique)
самосовмещенная структура
транзистора, сформирован-
ная с помощью повторного
процесса локального окис-
ления

SAE (surface anisotropic etch)	ческого поглощения и умножения носителей
анизотропное травление поверхности	SAM-laser (single axial mode laser)
SAGM-APD (separate absorption, grading and multiplication APD)	лазер с одной аксиальной модой
лавинный фотодиод с раздельными областями поглощения, градиента состава и умножения носителей	SANS (small-angle neutron scattering)
SAINT FET (self-aligned implantation for n ⁺ -layer technology)	малоугловое рассеяние нейтронов
технология n ⁺ -канального ПТ с самосовмещением и ионной имплантацией	SAPCVD (sputter assisted plasma CVD)
SALI (surface analysis by laser ionization)	химическое осаждение из паровой фазы с плазменным распылением
поверхностный анализ методом лазерной ионизации	SAPS (self-aligned process by side-wall technology)
SALT (special air leak test)	диффузионный процесс с самосовмещением с использованием боковых стенок
воздушное течеискание	SAR MOS (self-aligned refractory MOS)
SAM (scanning Auger microprobe)	МОП ПТ с самосовмещенным затвором из тугоплавкого металла /Mo/
растровый оже-микроанализ	SAXS (small-angle X-ray scattering)
SAM (scanning Auger microscopy)	малоугловое рассеяние рентгеновского излучения
растровая оже-микроскопия	SBD (Schottky-barrier device)
SAM (scanning acoustic microscopy)	прибор с барьером Шоттки
растровая акустическая микроскопия	SBD (Schottky-barrier deflector)
SAM-APD (separated absorption-multiplication APD)	оптический дефлектор с барьером Шоттки
лавинный фотодиод с раздельными областями опти-	SBF (Schottky barrier formation)
	формирование барьера Шоттки

SBG-GEDD (Schottky-barrier-gate Gunn-effect digital device)
цифровой прибор на диоде Ганна с затвором Шоттки

SBH (Schottky-barrier height)
высота барьера Шоттки

SBH (strip buried heterostructure)
скрытая меза-полосковая структура

SBN ($\text{Sr}_{0,61}\text{Ba}_{0,39}\text{Nb}_2\text{O}_6$)
ниобат стронция-бария /СБН/ /сегнетоэлектрики/

SBR-laser (Schottky-barrier restriction laser)
лазерный диод с ограничением /тока/ барьером Шоттки

SBS (stimulated Brillouin scattering)
стимулированное бриллюэновское рассеяние

SBZ (surface Brillouin zone)
поверхностная зона Бриллюэна

SC (solar cell)
солнечный элемент

SC (simple cubic)
простая кубическая решетка

SCANIR (surface compositional analysis by neutral and ion impact radiation)
анализ поверхностного состава путем спектро-

скопии ионостимулированного излучения

SCC (short-circuit current)
ток короткого замыкания

SCC (short-coupled cavity)
короткий связанный резонатор

SCC SML (short-coupled cavity single-mode laser)
одномодовый лазер с коротким связанным резонатором

SCF (self-consistent field)
самосогласованное поле

SCH-laser (separate-confinement heterostructure laser)
гетеролазер с раздельным /электрическим и оптическим/ ограничением /РО/

SCIC (semi-custom IC)
полузаказная интегральная микросхема

SCL (space charge layer)
слой пространственного заряда

SCL (space-charge limited)
/транзистор/ в режиме ограничения тока пространственным зарядом

SCLA (symmetric coupled laser array)
матрица лазерных диодов с симметричными связями

- SCLC (space-charge limited current)
ток, ограниченный пространственным зарядом
- SCM (scanning cathodoluminescence microscopy)
растровая катодолюминесцентная микроскопия
- SCM (scanning capacitance microscopy)
растровая емкостная микроскопия
- SC MOS (short-channel MOS)
планарный МОП ПТ с коротким каналом
- SC MOSFET (Schottky-clamped MOSFET)
МОП ПТ с фиксирующим /демпфирующим/ диодом Шоттки
- SCPT (Schottky-collector phototransistor)
фототранзистор с коллекторным барьером Шоттки
- SCR (space-charge region)
область пространственного заряда /ОПЗ/
- SCRIBE process (subnanometer cutting and ruling by an intense beam of electrons)
резка и разделение /подложек/ интенсивным электронным лучем сечением < 1 нм /скрайбирование/
- SCTJ (surface-channel tunnel junction)
туннельный переход с поверхностным каналом
- SD (Si-doped)
легированный кремнием
- SD (sputter deposition)
осаждение пленок методом катодного распыления
- SDA (spherical deflector analyzer)
сферический отклоняющий энергоанализатор
- SDHT (selectively-doped heterotransistor)
селективно-легированный гетеротранзистор
- SDP (sputter depth profile)
глубинное профилирование с применением ионного распыления
- SDS (semiconductor-dielectric-semiconductor)
см. SIS
- SDT (sputter deposition technique)
метод нанесения пленок распылением
- SE (secondary electron)
вторичный электрон
- SE (solvent evaporation)
процесс напыления растворителя /проявление фоторезиста/

SE (spectroellip- sometry)	SEI (selective epi- taxial isolation)
спектроэллипсометрия	изоляция методом селе- ктивной эпитаксии
SE(L) (surface emitting laser)	SELD (surface-emitting laser diode)
см. SELD	лазерный диод с поверх- ностным излучением
SEBL (scanning ele- ctron-beam litho- graphy)	см. также SE(L)
растровая электронолито- графия	SELOX (selective oxidation)
SEC (secondary electron conductivity)	селективное окисление
вторично-электронная /на- веденная/ проводимость	SEM (secondary-elect- ron multiplier)
SECS (solar energy conversion system)	вторично-электронный ум- ножитель /ВЭУ/
система преобразования солнечной энергии	SEM=EBIC
SEE (secondary elect- ron emission)	растровый электронный микроскоп в режиме наве- денного тока
вторично-электронная эмиссия	SEP (selective epita- xial planar process)
SEED (self-electro- optic-effect device)	планарная технология с использованием селектив- ной эпитаксии
оптоэлектронный прибор с собственным электроопти- ческим эффектом	SEPHD (single-electron pulse-height distribu- tion)
SEES (secondary elect- ron emission spect- roscopy)	одноэлектронное амплитуд- ное распределение
вторично-электронная спектроскопия	SEPI (short excitation and prolonged interro- gation)
см. также SES	метод короткого возбужде- ния и длительного опроса /в спектроскопии комби- национного рассеяния с временным разрешением/
SEG (selective epita- xial growth)	SEPOS (self-defined polisilicon sidewall)
селективная эпитаксия	технология ИС с самоог-
SEI (secondary elect- ron imaging)	
изображение во вторичных электронах	

раничивающей поликремниевой изоляцией боковой стенки

SER (short external resonator)

короткий внешний резонатор

SER MOSFET (sputter-etched refractory MOS FET)

полевой МОП транзистор с затвором, сформированным из тугоплавкого металла путем ионного травления

SERS (surface-enhanced Raman scattering)

усиленное поверхностью комбинационное рассеяние

SES (secondary-electron spectroscopy)

см. SEES

SESCA (scanning ESCA)

растровая электронная спектроскопия для химического анализа

SEXAFS (surface EXAFS)

поверхностная спектроскопия тонкой структуры протяженных спектров рентгеновского поглощения

SF (stacking faults)

дефекты упаковки

SFET (surface FET)

поверхностный полевой транзистор

SFM (split-field magnet)

целевой магнит

SFR(L) (spin-flip Raman laser)

перестраиваемый лазер на комбинационном рассеянии с обращением спина

SGRPA (spherical-grid retarding potential analyzer)

энергоанализатор типа задерживающего потенциала со сферическими сетками

SG-silicon (semiconductor-grade si)

кремний полупроводникового качества

SGSIT (surface-gate SIT)

транзистор со статической индукцией с поверхностным затвором

SHEED (scanning HEED)

сканирующий метод дифракции быстрых электронов

SHG (second harmonic generation)

/нелинейная оптическая среда/ с генерацией второй гармоники

SI (semi-insulating)

полуизолирующий

SIA (surface and interface analysis)

анализ поверхностей и границ раздела

SIB (showered ion beam)

нефокусированный пучок ионов /для ионной имплантации и ионного травления/

- SIBL (scanning ion-beam lithography)
растровая ионолитография
- SICOS (side-wall-base contact structure)
структура с боковым контактом базы
- SID (semiconductor imaging device)
полупроводниковый преобразователь изображения
- SIES (sputtering-induced emission spectroscopy)
спектроскопия оптического излучения, индуцированного распылением
см. также SIPS
- SIGFET (semi-insulated-gate FET)
полевой транзистор с полужолированием затвором
- SiG MOS (Si-gigabit=SiN MOS)
кремниевая n-МОП ИС, обеспечивающая передачу информации со скоростью ~ Гбит/с
- SIIMS (secondary ion imaging mass-spectrometer)
вторично-ионный микроскоп-масс-анализатор
- SIIP (spectroscopy of ion-induced photons)
спектроскопия ионостимулированного излучения
- SILO (sealed interface local oxidation)
межэлементная изоляция локальным прокислением
- эпитаксиального слоя до подложки
- SIM (scanning ion microscope)
растровый ионный микроскоп
- SIMIS (stepped insulator MIS)
МДП структура со ступенчатым профилем изолятора
- SIMMWIC (silicon millimeter-wave IC)
кремниевая ИС миллиметрового диапазона волн
- SIMOX (separation by implanted oxygen)
окисная изоляция имплантацией ионов кислорода в кремний
- SIMS (secondary-ion mass-spectrometry)
вторично-ионная масс-спектрометрия /ВИМС/
- SIOV (Siemens oxide-metal varistor)
варистор со структурой металл-оксид фирмы Сименс
- SIP (sputter ion plating)
нанесение покрытий методом ионного распыления
- SIPS (sputter-induced photon spectroscopy)
см. SIES
- SIPT (static induction phototransistor)
фототранзистор со статической индукцией /СИФТ/

SIPT(hy) (static induction photothyristor)
фототиристор со статической индукцией

SIRIS (sputter-initiated resonance ionization spectroscopy)
резонансная ионизационная спектроскопия при распылении

SIS (semiconductor-insulator-semiconductor)
структура полупроводник-диэлектрик-полупроводник /ПДП/
см. также SDS

SISFET (semiconductor-insulator-semiconductor FET)
полевой транзистор с ПДП структурой /ПДП-ПТ/
INFET (Schottky injection FET)
ПТ с инъекцией неосновных носителей через барьер Шоттки

SITHy (static induction thyristor)
тиристор со статической индукцией

SJ (shallow junction)
мелкий переход

SJT (semiconductor junction transistor)
полупроводниковый плоскостной биполярный транзистор

SL (slave laser)
связанный лазер с инжекционным затвором /с внешним запуском/

SL (superlattice)
сверхрешетка

SLEB (swept-line electron beam) annealing
отжиг сканирующим электронным лучем

SLEEP (scanning low energy electron probe)
сканирующий электронный зонд с низкой энергией

SLM (scanning laser microscope)
растровый лазерный микроскоп

SLM (single longitude mode) operation
режим одной продольной моды

SLP (single-layer polysilicon)
однослойное поликремниевое покрытие

SLPT (super-linear power transistor)
мощный сверхлинейный транзистор

SL-QWH (strained-layer quantum-well heterostructure)
напряженная гетероструктура с квантоворазмерным эффектом

SLS (strained-layer superlattice)
см. SSL

SMA (spherical mirror analyzer)
сферический зеркальный энергоанализатор

SMA (surface mounted assembly) сборка с поверхностным монтажом	SNMS (sputtered neutrals mass-spectrometry) масс-спектрометрия распыленных атомов /в высокочастотной плазме/
SMC (surface mounted component) элемент с поверхностным монтажом	SNR (signal-to-noise ratio) отношение сигнала к шуму
SMCP (single MCP) одиночная микроканальная пластина /с изогнутыми каналами/	SNR (silicone-based negative resist) негативный резист на силиконовой основе
SMD (surface-mounted device) прибор с поверхностным монтажом	SNS-JJ (superconductor-normal-superconductor Josephson junction) переход Джозефсона со структурой сверхпроводник-нормальный проводник-сверхпроводник
SMG (substrate-mesa-guide) волноводная меза-структура в подложке	SOC (Si-on-ceramic) кремний на керамике
SMIS (surface MIS) МДП структура с поверхностным каналом	SOF (Si-on-fabric) кремний на ткани
SML (single-mode laser) одномодовый лазер	SOG (spin on glass) /планаризация/ загонкой стеклянной фритты
SMMW (submillimeter-wave) субмиллиметровый диапазон волн	SOGICON (semiconductor oscillation generator by injection and constriction) полупроводниковый генератор на принципе инъекции и сжатия
SMOS (submicrometer-channel MOS) субмикронная МОП ИС	SOLID (silicide-on-lightly-doped-drain) МОП ПТ со слоем силицида на слабелегированном стоке /в целях уменьшения паразитного сопротивления сток-исток/
SMT (surface mounting technology) технология поверхностного монтажа	
SNMS (secondary neutrals mass-spectrometry) масс-спектрометрия вторичных нейтральных атомов	

SOM (scanning optical microscopy)	SPIPES (spin-polarized inverse photoemission spectroscopy)
растровая оптическая микроскопия	спектроскопия тормозного излучения, возбужденного спинполяризованными электронами
SOP (small outline package)	SPO (surface plasma oscillations)
малогобаритный корпус	поверхностные плазмоны
SOR (synchrotron optical radiation)	SPRITE (signal processing in the element)
оптическое излучение синхротрона	матричный приемник изображения с преобразованием сигнала внутри элемента /в режиме временной задержки и накопления/
см. также SR (synchrotron radiation)	см. также TDI, TED
SPAD (single-photon avalanche diode)	SPS (space-use solar cell)
лавинный фотодиод с однофотонным разрешением	солнечный элемент для использования в космосе
SPC (semitransparent photocathode)	SPS (synchrotron-radiation induced photoemission spectroscopy)
полупрозрачный фотокатод	см. SRPES
SPD (selfscanned photodiode)	SQS (self-quenching streamer)
самосканирующая фотодиодная матрица	самогасящийся стример
SPD (Si-photodiode)	SQW (single quantum well)
кремниевый фотодиод	одиночная квантовая яма
SPDA (silicon photodiode array)	см. также SW
кремниевая фотодиодная матрица	SQW FET (strained-quantum well FET)
SPE (solid phase epitaxy)	ПТ на основе напряженной сверхрешетки
твердофазная эпитаксия	SQWT (single quantum-well transistor)
SPIEI-laser (separately pumped integrated etalon interference laser)	структура транзистора с одиночной квантовой ямой
эталонный лазер со встроенным интерферометром и отдельной накачкой	

SR (space-resolved)
с пространственным разрешением

SR (synchrotron radiation)
синхротронное излучение
см. также SOR

SRO (short-range order)
ближний порядок /атомная корреляция в пределах первых атомных оболочек/

SRO (stress relief oxide)
напряженная рельефная пленка окисла на поверхности кремния /напряжения, связанные с рельефом окисной пленки/

SRP (spreading-resistance probe)
зонд распределенного сопротивления

SRP (spreading resistance profiling)
метод контроля материала по профилю распределенного сопротивления

SRPES (synchrotron radiation photoemission spectroscopy)
фотоэлектронная спектроскопия с возбуждением синхротронным излучением
см. также SPS

SRPL (spatially-resolved photoluminescence)
метод фотолюминесценции с пространственным разрешением

SRS (stimulated Raman scattering)
стимулированное комбинационное рассеяние

SRS (synchrotron radiation source)
источник синхронного излучения

SS (solid state)
твердое тело

SS (stainless-steel)
нержавеющая сталь

SS (surface states)
поверхностные состояния

SSA (self-scanned array)
самосканирующая матрица

SSBH (self-aligned strip buried heterostructure)
скрытая самосовмещенная полосковая гетероструктура

SSC (source current control)
способ введения примеси в эпитаксиальную пленку путем регулирования тока через источник

SSCH-laser (stepped separate-confinement heterostructure laser)

лазерный диод со ступенчатой гетероструктурой с отдельным ограничением

SSD (solid state detector)
твердотельный детектор /ионизирующих излучений/

SSD (synthesis solute-diffusion)
метод выращивания /монокристаллов/ из раствора в расплаве по схеме синтеза-диффузия

²DHT (superlattice selectively-doped heterotransistor)
селективно-легированный гетеротранзистор со сверхрешеткой

SSE (separate-source evaporation)
испарение из отдельных источников

SSEM (stroboscopic SEM)
РЭМ в режиме стробирования

SSIMS (static SIMS)
статическая вторично-ионная масс-спектрометрия

SSL (strained superlattice)
напряженная сверхрешетка см. SLS

SSNTD (solid-state nuclear track detector)
твердотельный детектор треков ядерных частиц

SSP (scanning surface photovoltage) technique
анализ поверхностного фотонапряжения со сканированием

SSR (solid-state recrystallization)
рекристаллизация

SSS (slow surface states)
медленные поверхностные состояния

SST (sealed sidewall trench)
бездефектная изоляция заполненными канавками в боковой стенке

SST (small-sized transistor)
малоразмерный транзистор /элемент ИС/

SST (super self-align technology)
технология самосовмещения с высокой точностью

SSTWA (solid-state travelling-wave amplifier)
твердотельный усилитель бегущей волны

STM (scanning tunneling microscopy)
растровая туннельная микроскопия

STPV (solar thermophotovoltaic) cell
термо-фотогальванический солнечный элемент

STRS (stimulated thermal Rayleigh scattering)
термостимулированное рэлеевское рассеяние

STXM (scanning transmission X-ray microscopy)
растровая просвечивающая рентгеновская микроскопия

- SUS (substrate-graded stainless steel)
подложка из нержавеющей стали высокого качества /с зеркально отражающей поверхностью/
- SV (silicon vidicon)
видикон с кремниевой мишенью /кремникон/
- SW (single well)
см. SQW
- SWAMI (side-wall-masked isolation)
метод изоляции боковыми стенками
- SWI (semi-well isolation)
полуглубинная изоляция /путем диффузии в часть эпитаксиального слоя/
- SWIR (short-wave IR)
коротковолновая ИК область спектра
- SWO (single-wavelength operation)
одномодовый режим
- SWS (slow-wave structure)
замедляющая система
- SXA (soft X-ray absorption spectroscopy)
спектроскопия поглощения мягкого рентгеновского излучения
- SXAPS (soft X-ray appearance potential spectroscopy)
спектроскопия потенциалов появления мягкого рентгеновского излучения
- SXDA (soft X-ray emission depth profile analysis)
глубинное профилирование с использованием мягкого рентгеновского излучения
- SXE (soft X-ray emission)
мягкое рентгеновское излучение
см. также SXR
- SXES (soft X-ray emission spectroscopy)
спектроскопия мягкого рентгеновского излучения
- SXM (scanning X-ray microscopy)
растровая рентгеновская микроскопия
- SXPS (soft-X-ray photoemission spectroscopy)
фотоэлектронная спектроскопия при возбуждении мягким рентгеновским излучением
- SXR (soft X-ray)
см. SXE

T

- TAC (thermal accommodation coefficient)
коэффициент термической аккомодации /газов/
- TAEM (transmission analytical electron microscopy)
аналитическая просвечивающая электронная микроскопия

TAP (tape automated bonding)
автоматизированная приклеива-
лка /элементов ИС/ на ленту

TAV (transverse acoustoelectric voltage)
поперечное акустоэлектрическое напряжение

TB (tunable birefringence)
перестраиваемое двойное лучепреломление

TBP (triangular-barrier photodiode)
фотодиод с треугольным /потенциальным/ барьером

TC (transistor cell)
транзисторная ячейка

TCBC-laser (three-channel buried-crescent laser)
трехканальный лазерный диод со скрытой серповидной активной областью

TCC (transparent conductive coating)
прозрачное проводящее покрытие
см. также CTC

TCDS (tandem cylindrical deflector spectrometer)
сдвоенный цилиндрический отклоняющий спектрометр

TCE (thermal coefficient of expansion)
см. TEC

TCL (transparent conductive layer)
прозрачный проводящий слой

TCL (twin channel laser)
двухканальный лазерный диод

TCM (thermal conduction module)
теплопроводящий керамический модуль /для корпусов ИС/

TCO (transparent conductive oxide)
прозрачный проводящий окисел

TCS (total current spectroscopy)
спектроскопия полного тока

TCSM (twin-channel-substrate mesa-guide)
меза-полосковая структурой с двойным каналом в подложке

TD (thermal diffusion)
термодиффузия

TD (thermal donor)
термодонор

TD (thermodesorption)
см. TSD

TDH-laser (twisted double heterostructure laser)
двойной гетеролазер с закрученной активной областью
см. также TDS

TDI (time-delay-integration)
режим временной задержки и накопления /ВЗИ/
см. также SPRITE, TED

- TDL (tunable diode laser)
перестраиваемый диодный лазер
- TDMCVP (temperature difference method under controlled vapour pressure)
выращивание методом разности температур при регулируемом давлении пара
- TDMS (thermal desorption mass-spectrometry)
термодесорбционная масс-спектрометрия
- TDS (thermodesorption spectroscopy)
термодесорбционная спектроскопия
- TDS (twisted double heterostructure)
см. TDH
- TE-cooled (thermo-electricity cooled)
с термоэлектрическим охлаждением
- TEA (tunnel-emission amplifier)
усилитель на туннельной эмиссии
- TEA-CO₂-laser (transverse-excited atmospheric CO₂ laser)
лазер на CO₂ с атмосферным давлением с поперечным возбуждением
- TEC (thermal expansion coefficient)
коэффициент термического расширения
см. также TSE
- TEC (thermionic energy converter)
термоэмиссионный преобразователь энергии /ТЭП/
- TED (Tom Elliot detector)
см. TDI, SPRITE
- TED (total energy distribution)
распределение по полным энергиям
- TED (transmission electron diffraction)
дифракция электронов в просвечивающем режиме
- TEG(a) (triethyl-gallium)
триэтилгаллий
- TEG (two-dimensional electron gas)
двумерный электронный газ
см. также 2DEG, 2D-E
- TEG FET (two-dimensional electron gas FET)
ПТ с двумерным электронным газом /на гетероструктуре с затвором Шоттки/
- TEI(n) (triethyl-indium)
триэтилиндий
- TELEC (thermoelectronic laser energy converter)
термоэлектронный преобразователь энергии лазерного излучения
- TELIP (temperature-limited infrared photo-detector)
приемник ИК излучения в

режиме ограничения тепловым шумом

TELS (transmission energy loss spectroscopy)
спектроскопия потерь энергии /электронов/ в просвечивающем режиме

TEME (thermo-electromotive force)
термо-э.д.с.

TEN₂-laser (transverse-excited N₂ laser)
азотный лазер с поперечным возбуждением

TESS (thermal expansion shear separation)
разделение слоев с использованием разности термического расширения

TFE (thermionic-field emission)
термостимулированная автоэлектронная эмиссия /автотермоэмиссия/

TFEG (tetrode field-emission gun)
тетродная электронная пушка с автоэмиссионным катодом

TFEL (thin-film electroluminescent)
тонкопленочный электролюминесцентный /излучатель/

T-FET (T-gate structure FET)
ПТ с затвором Т-образной формы

TGD (thermally-generated defect)

термически генерированный дефект

TG LPE (temperature gradient LPE)
жидкофазная эпитаксия с температурным градиентом

TGM (toroidal grating monochromator)
монохроматор с тороидальной дифракционной решеткой

TНВ (temperature-humidity-bias)
испытания в режиме повышенных температуры-влажности-смещения

THEED (transmission HEED)
дифракция быстрых электронов в просвечивающем режиме

THG (two-dimensional hole gas)
двумерный дырочный газ см. также 2DHG, 2D-H

TНМ (travelling heater method)
метод движущегося нагревателя /зонного растворения/ при выращивании кристаллов из раствора в расплаве

TIL GTO (two interdigitation levels GTO)
двухоперационный триодный тиристор с двойной встречно-штыревой конструкцией

TIP (trench isolation process)
технология ИС с изоляцией

канавками / вместо локального окисления КНС/

TJC (tandem-junction cell)

сдвоенный / двухпереходный/ элемент

TJS (transversal-junction strip)

поперечный полосковый переход

см. также TS

TLD (thermoluminescent dosimeter)

термолюминесцентный дозиметр

TLR (tri-level resist)

трехслойное маскирование

TLW (three-layer-waveguide)

трехслойный волновод

TMG (trimethyl-gallium)

триметилгаллий

TMI (trimethylindium)

триметилиндий

TMOS (trench MOS)

МОП структура с затвором в канавке прямоугольной формы

TMP (turbomolecular pump)

турбомолекулярный вакуумный насос

TN (twisted nematic)

скрученный нематик

TOF (time of flight)

времяпролетный

TOFA (time-of-flight analysis)

времяпролетный метод анализа

TOFAP (time-of-flight atom probe)

времяпролетный атомный зонд

TOFISS (time-of-flight ion scattering spectrometer)

времяпролетный спектрометр рассеянных ионов

TOFMS (time-of-flight mass-spectrometer)

времяпролетный масс-спектрометр

TOK (transverse optical klystron)

поперечный оптический клистрон

TOM (temperature oscillating method)

метод осциллирующей температуры / выращивания монокристаллов в вертикальной печи/

TOPMOST (Toshiba program MOS transistor)

МОП транзистор, изготовленный по программе фирмы Тосиба

TPC (time projection chamber)

времяанализирующая камера

TPD (temperature-programmed desorption)

температурно-программируемая десорбция

TPRS (two-photon Raman scattering)
двухфотонное комбинационное рассеяние

TPV (thermophotovoltaic)
термофотогальванический /эффект/

TR (time-resolved)
с временным разрешением

TR EELS (time-resolved EELS)
спектроскопия энергетических потерь электронов с временным разрешением

TRIMOS (triac MOS)
МОП-триак /МОП тиристор с симметричной характеристикой/

TRLIF (time-resolved laser-induced fluorescence)
спектроскопия возбужденной лазером флуоресценции с временным разрешением

TRS (thermoreaction spectroscopy)
терморекционная спектроскопия

TRS (time-resolved spectroscopy)
спектроскопия с временным разрешением

TRS-laser (twin-ridge substrate laser)
лазерный диод с двойным ребром в подложке

TS (terraced substrate)
террасированная подложка

TS (transversal-junction strip)
см. TJS

TSB (trenched Schottky barrier)
барьер Шоттки, сформированный в канавке

TSC (thermally stimulated conductivity, current)
термостимулированная проводимость /ток/

TSCAP (thermally stimulated capacitance)
термостимулированная емкость

TSD (thermally stimulated desorption)
термостимулированная десорбция /термодесорбция/

TSD (thermally stimulated discharge)
термостимулированный разряд

TSDS (tandem spherical deflector spectrometer)
сдвоенный сферический отклоняющий спектрометр

TSE (thermostimulated exoemission)
см. TSEE

TSEE (thermally stimulated exoelectron emission)
термостимулированная экзoeлектронная эмиссия
см. также TSE

TSEM (transmission secondary electron multiplier)

электронный умножитель
с прострельными диодами

TSFZ (travelling
solvent floating zone)
см. TSM

TSI (titanic-scale
integration)
сверхвысокая степень инте-
грации /СВИС/

TSIC (thermally stimu-
lated ionic current)
термостимулированный ион-
ный ток

TSL (thermally stimu-
lated luminescence)
термостимулированная лю-
минесценция, термолюми-
несценция

TSM (thermally stimu-
lated current and ca-
pacitance measurements)
измерение термостимулиро-
ванных тока и емкости

TSM (travelling solvent
method)
зонная плавка с темпера-
турным градиентом
см. также TSFZ

TSN-LED (transparent-
substrate-nitride
light-emitting diode)
светодиод на прозрачной
просветленной нитридом
кремния подложке

TSSG (top-seeded so-
lution growth)
вытягивание /кристалла/
на затравку из раствора
в расплаве

TTED (transit-time
effect device)
прибор на основе пролет-
ного эффекта

TTT (two-terminal
thyristor)
двухполюсный тиристор пе-
реключатель

TTWT (transverse-beam
TWT)
лампа бегущей волны с по-
перечным лучом

TUNNETT (tunnel-injec-
tion transit-time)
туннельный инжекционно-
пролетный диод

TWA (travelling-wave
amplifier)
см. TWTA

TWF (travelling-wave
FET)
полевой транзистор с бе-
гущей волной /длинная
структура с распределен-
ными параметрами/

TWK (travelling-wave
klystron)
клизотрон бегущей волны
TWP (travelling-wave
phototube)
фото-ЛБВ

TWR (travelling-wave
resonator)
резонатор бегущей волны

TWT (travelling-wave
tube)
лампа бегущей волны /ЛБВ,
TWT (L) (travelling-
wave type laser)
лазер бегущей волны

TWT DHL (travelling-wave type double heterostructure laser)
двойной гетеролазер бегущей волны

TWTA (travelling-wave tube amplifier)
усилитель на ЛВБ
см. также TWA

TXRT (transmission X-ray topography)
просвечивающая рентгеновская топография

U

UBIS (ultraviolet bremsstrahlung isochromat spectroscopy)

спектроскопия изохроматического тормозного УФ излучения /электрон-фотонная спектроскопия/
см. также BIS, IPES, IPE

UCBF (undercut and backfill)
техника подтравы и заполнения /изоляция/

UCP (ubiquitous crystallization process)
стандартный /обычный/ процесс кристаллизации

UDT (unidirectional transducer)
однонаправленный преобразователь ПАВ

UHVA (ultrahigh-vacuum arc)
сверхвысоковакуумный дуговой разряд

U-ISO (U-groove isolation)
изоляция U-образной канавкой

ULISYS (ultrasonic imaging system)
ультразвуковая система отображения

UMOS (U-groove MOS)
полевой МОП транзистор с U-образной канавкой

UPBI (U-grooved PBT)
транзистор с проникаемой базой с U-образной канавкой

UPS (UV-photoemission spectroscopy)
УФ фотоэлектронная спектроскопия /УФЭС/

UVC (UV-to-visible converter)
преобразователь УФ излучения в видимое

UVEPROM (ultraviolet-erasable PROM)
программируемое ПЗУ со стиранием УФ облучением

UVLSI (ultra-very-large scale integration)
сверхвысокая степень интеграции /СВИС/

V

VACL (vacuum arc current limited)
режим, ограниченный током вакуумного пробоя

VB (valence band)
валентная зона

VBDOS (valence band density of states) плотность состояний в валентной зоне	VEELS (vibrational electron energy loss spectroscopy)
VBM (valence band maximum) вершина валентной зоны	колебательная спектроскопия потерь энергии электронов
VBS (variband structure) варизонная структура	VHEED (very high energy electron diffraction)
VBT (valence band top) вершина валентной зоны	дифракция очень быстрых электронов
V-CCD (vertical CCD) ПЗС /со скрытым каналом/ с вертикальной организацией	VIC (vacuum integrated circuit) вакуумная интегральная микросхема
VCNR (voltage-controlled negative resistance) отрицательное сопротивление, регулируемое напряжением	VIDIC (visible-to-IR dynamic image converter) динамический преобразователь видимого изображения в ИК /на основе жидкокристаллической светоклапанной панели/
VD ² MOSFET (vertical double-diffused dual-gate MOSFET) двухзатворный МОП ПТ с вертикальной геометрией, изготовленный методом двойной диффузии	VIPS-laser (V-grooved inner-strip on pInP substrate laser) лазерный диод с встроенной полосковой активной областью в V-образном канале в pInP подложке
VDI MOS (vertical double-implanted MOS) МОП транзистор с вертикальной геометрией, изготовленный методом двойной ионной имплантации	VIST (vertically isolated self-aligned transistor) транзистор с самосовмещенным затвором с изоляцией по вертикали
VDP (vacuum deposition) вакуумное осаждение	VLEED (very low energy electron diffraction)
VDP (Van der Pauw) теория /приближение/ Вандер-Пау	

дифракция очень медленных электронов

VLPE (vapour-liquid phase epitaxy)
гибридная парофазная-жидкофазная эпитаксия

VMCP (2 MCP in V-cascade)
шеvronное соединение 2 микроканальных пластин

VOD (vertical overflow drain)
вертикальный сток переполнения /в ПЗС с межстрочным или строчно-кадровым переносом/

VP CCD (virtual-phase CCD)
ПЗС с виртуальной фазой

VPE (vapour-phase etching)
парофазное травление

VPO (vapour-phase oxidation)
поверхностное окисление из паровой фазы

VPR (vapour-phase regrowth)
парофазное разращивание

VPS (vacuum plasma spraying)
плазменное струйное распыление в вакууме

VPTBH (vapour-phase transported buried heterostructure)
скрытая гетероструктура, полученная методом парофазного транспорта

VSB-laser (V-grooved substrate buried laser)
лазерный диод со скрытой структурой с v-образным каналом в подложке

VSIS-laser (V-channelled substrate inner stripe laser)
лазерный диод с встроенным v-образным полосковым каналом в подложке

VUV (vacuum ultra-violet)
вакуумный ультрафиолет /ВУФ/

VVC (voltage-variable capacitor)
варактор

W

WF (work function)
работа выхода

WHO (wet hydrogen oxidation)
окисление в атмосфере влажного водорода /при изготовлении СВИС с w-затвором во избежание окисления w/

X

XAES (X-ray-excited Auger electron spectroscopy)
электронная оже-спектрокопия с рентгеновским возбуждением

- XAFS (X-ray absorption fine structure)
тонкая структура спектров рентгеновского поглощения
- XANES (X-ray absorption near-edge structure)
структура спектра краевого рентгеновского поглощения
- XAS (X-ray absorption spectroscopy)
спектроскопия рентгеновского поглощения /адсорбционная спектроскопия/
- XD (X-ray diffraction)
см. XRD
- XEDS (X-ray-energy dispersive spectroscopy)
рентгеновская энергодисперсионная спектроскопия
- XES (X-ray emission spectroscopy)
спектроскопия рентгеновского излучения
- XMOS-transistor
ПТ с двумя затворами с дополняющими каналами на каждой поверхности рекристаллизованного слоя поликремния /для снижения эффекта короткого канала/
см. также Cross MOS
- XO (quartz crystal oscillator)
кварцевый вибратор
см. также CO
- XPD (X-ray photoelectron diffraction)
- дифракция рентгеновских фотоэлектронов
- XRA (X-ray absorption)
рентгеновское поглощение
- XRD (X-ray diffraction)
рентгеновская дифракция
см. также XD
- XRDS (X-ray diffuse scattering)
диффузное рассеяние рентгеновского излучения
- XRF (X-ray fluorescence)
рентгеновская флуоресценция
- XRL (X-ray lithography)
рентгенолитография
- XRM (X-ray microscopy)
рентгеновская микроскопия
- XRT (X-ray topography)
рентгеновская топография
- XCWIS (X-ray standing wave interference spectrometry)
спектроскопия интерференции стоячих волн рентгеновского излучения /метод анализа адсорбционных систем/
- XTEM (cross-sectional TEM)
просвечивающий электронный микроскоп в режиме секционного исследования /образцов с косым сечением/
- XUV (X-ray-UV region, extreme UV)
диапазон спектра между

УФ и рентгеновским излу-
чением /с длиной волны
1,5 - 20 нм/

Y

YS (yield spectroscopy)
спектроскопия /квантового/
выхода

YSZ (yttria-stabilized
zirconic)
двуокись циркония, стаби-
лизированная окисью иттрия

Z

ZD (zener diode)
стабилитрон

ZM (zone melting)
зонная плавка

ZMCP (3-4 MCP in
cascade)

Z-образное шевронное сое-
динение 3-4 микроканаль-
ных пластин /сборка МКП
с Z-конфигурацией/

ZMR (zone-melting
recrystallization)
рекристаллизация зонной
плавкой

ZO (zinc oxide)
оксид цинка /прозрачное
проводящее покрытие/

ZR (zone-refining)
зонная очистка

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РУССКИЕ АББРЕВИАТУРЫ:

ЗУ	запоминающее устройство
ЗУПВ	ЗУ с произвольной выборкой
ИК	инфракрасный
ИС	интегральная микросхема
КМОП	комплементарная МОП-структура
КНС	кремний-на-сапфире
ЛБВ	лампа бегущей волны
ЛПД	лавинно-пролетный диод
МАП	структура металл- Al_2O_3 -полупроводник
МДП	металл-диэлектрик-полупроводник
МДПДМ	металл-диэлектрик-полупроводник- диэлектрик-металл
МНОП	металл-нитрид кремния-окисел- полупроводник
МОНОП	металл-окисел-нитрид кремния-окисел- полупроводник
МОП	металл-окисел-полупроводник
МКП	микросканальная пластина
ПАВ	поверхностная акустическая волна
ПЭС	прибор с зарядовой связью
ПТ	полевой транзистор
РЭМ	растровый электронный микроскоп
СВЧ	сверхвысокая частота
ЭЛТ	электронно-лучевая трубка
ЭОП	электронно-оптический преобразователь
ЭПР	электронный парамагнитный резонанс
УФ	ультрафиолетовый

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
От составителей	3
Английские сокращения и их русские эквиваленты	4
Использованные русские аббревиатуры ..	110

Нина Александровна СОВОЛЕВА,
Ираида Петровна ВИШНЕВСКАЯ

АНГЛИЙСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИБОРАМ

Под редакцией канд. физ.-мат. наук С.Х. Батыгова

Редактор Г.Ф. Баталова

Технические редакторы Г.М. Аристова,
Н.К. Дудова

Корректор В.М. Фадеева

Подп. в печать 13.06.86. Формат 60x84/16. Бум. офс. №2.
Печ. офсетная. Усл. печ. л. 6,51. Усл. кр.-отт. 6,70.
Уч.-изд. л. 5,28. Тираж 3000 экз. Заказ №4970 Цена 1 р.

Всесоюзный центр переводов научно-технической
литературы и документации

117218, Москва В-218, ул. Кржижановского, д.14, к.1

ПИК ВИНТИ, 140010, Моск., обл., Октябрьский просп., 403

Англ. сокр. по электрон. приборам, 1986, 1—112